

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ  
К ЖУРНАЛУ «ФИЗИКА И ТЕХНИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВ»

том 22 1988 год

- А бакумов В. Н., Карпус В., Перель В. И., Яссьевич И. Н. Влияние заряда глубокого центра на многофононные процессы термоионизации и захвата электронов. 2, 262
- А бдулгафаров С. Е., Кока А. П., Мукашев Б. Н., Наурзалин Р. Е., Талибаев Б. М., Токарев Ю. Н. Исследование свойств пленок  $\alpha$ -Si:H, имплантированных  $V^+$  и  $BF_2$ . 7, 1171
- А бдуллин Х. А., см. Мукашев Б. Н. 6, 1020
- А бдуманапов У. Ж., см. Аблова М. С. 1, 20
- А бдуманапов У. Ж., см. Регель А. Р. 1, 161
- А бдураимов А., см. Бахадырханов М. К. 1, 123
- А бдурахманов К. П., Закс М. Б., Касаткин В. В., Куликов Г. С., Першеев С. К., Ходжаев К. Х. Диффузия фосфора в профилированном кремнии, полученном способом А. В. Степанова. 11, 2088
- А бдурахманов К. П., Шеримбетов Т., Добровинский Ю. М., Сагдуллаев Х. У. Радиационное дефектообразование в диодных структурах при облучении электронами с различной интенсивностью. 3, 510
- А бдурахманов К. П., см. Аблова М. С. 1, 20
- А бдусаттаров А. Г., Емцев В. В., Машовец Т. В. Влияние интенсивности импульсного электронного облучения на образование дефектов в  $p$ -кремнии. 3, 502
- А блова М. С., Абдуманапов У. Ж., Абдурахманов К. П., Куликов Г. С., Уткин-Эдин Д. П., Ходжаев К. Х. Исследование однородности легирования и влияния легирующей примеси фосфора на электрофизические параметры тонких пленок аморфного гидрированного кремния. 1, 20
- А блова М. С., см. Регель А. Р. 1, 161
- А блязимова Н. А., Вейнгер А. И., Питанов В. С. Электрические свойства кремниевых  $p$ - $n$ -переходов в сильных СВЧ полях. 11, 2001
- А вержьянов В. Л., Звонарева Т. К., Л юбин В. М., Норцева Н. В., Павлов Б. В., Сарсембинов Ш. Ш., Цэндин К. Д. Двойное модифицирование стеклообразного селенида мышьяка. 11, 2093
- А враменко В. А., Стриха М. В. Ударная ионизация в дырочном антимониде индия. 6, 1117
- А врутин Е. А., Портной М. Е. Оценка времени жизни неравновесных носителей заряда в полупроводнике, облученном тяжелыми ионами. 8, 1524
- А гекян В. Ф., Александров Б. Г., Степанов Ю. А. Механизм низкотемпературного стимулированного излучения света в твердых растворах  $Al_0.5V_0.5$ . 12, 2240
- А гзамов А. А., см. Регель А. Р. 6, 1144
- А гринская Н. В. Термическая энергия мелких доноров и акцепторов в кристаллах  $CdTe$ . 9, 1684
- А гринская Н. В., Шашкова В. В. Влияние отклонения от стехиометрии на природу мелких акцепторных состояний в кристаллах  $CdTe$ . 7, 1248
- А ёшин А. И., Антонова И. В., Васильев А. В., Панов В. И., Шаймеев С. С. Влияние интенсивности облучения быстрыми нейтронами на процессы дефектообразования в кремнии. 4, 692
- А кимов Б. А., Албул А. В., Никрич А. В., Широкова Н. А., Рябова Л. И. Неравновесные состояния, индуцированные ИК подсветкой в сплавах  $Pb_{1-x}Sn_xTe$  ( $x \sim 0.22$ ) с различным содержанием индия. 2, 248
- А кимов О. Е., см. Филиков В. А. 5, 958
- А кимова Е. А., см. Андриеш А. М. 2, 289
- А копян А. А., Витусевич С. А., Малютенко В. К. Теоретическое и экспериментальное исследование эксклюзии в образцах конечной длины. Переходный процесс при включении поля и нестационарные вольтамперные характеристики. 3, 471
- А ксенов В. Ю., см. Алфёров Ж. И. 10, 1775
- А ксенов И. А., Лукомский А. И., Маковецкая Л. А., Рубцов В. А. Краевое поглощение и ширина запрещенной зоны твердых растворов  $CuAl_xIn_xS_{1-x}$ . 5, 961

- Акулова Ю. А., Яковенко А. А., Груздов В. Г., Гуламов Р. А., Корольков В. И., Мезрин О. А. Исследование особенностей переноса носителей в гетероструктурах с тонкими активными областями. 7, 1287
- Акулович Н. И., Быковский В. А., Гирий В. А., Горупа К. С., Коршунов Ф. П., Утенко В. И. Отжиг ядерно легированного арсенида галлия.\* 9, 1720
- Албул А. В., см. Акимов Б. А. 2, 248
- Александров Б. Г., см. Агекян В. Ф. 12, 2240
- Александров П. А., Баранова Е. К., Городецкий А. Е., Демаков К. Д., Кутукова О. Г., Шемардов С. Г. Исследование распределения аморфной и кристаллической фазы ионно-синтезированного SiC в Si. 4, 731
- Алексеев Е. С., Литинский Л. Б., Лихтер А. И. Расчет зонной структуры германия с использованием фиктивных сфер. 11, 2059
- Алексеев М. А., Карлик И. Я., Мирлин Д. Н., Сапега В. Ф. Гофрировка валентной зоны кристаллов фосфида индия. 4, 569
- Алексеева З. М., Диамант В. М., Красильникова Л. М., Криворотов Н. П., Пороховниченко Л. П. Эффекты анизотропии сжатия в эпитаксиальных слоях GaAs, легированных серой, при всестороннем давлении. 10, 1743
- Алексеев М. В., Андреев А. Г., Забродский А. Г., Попов В. В. Экспериментальное определение холл-фактора в сложной валентной зоне p-Ge. 1, 140
- Алешкин В. Я., Додин Е. П., Козлов В. А., Нефедов И. М., Романов Ю. А. Структура распределения горячих дырок германия в условиях стриминга. 11, 1910
- Алибаев А. С., Камиллов Т. С., Першеев С., Сиябеков Х. Б., Туланов В. Фотоэлектрические характеристики кремния, легированного марганцем, при работе в качестве фоточувствительного электрода газоразрядной ячейки.\* 3, 566
- Алибаев А. С., Сиябеков Х. Б., Туланов В. Особенности несамостоятельного газового разряда в ячейке с полупроводниковым электродом.\* 3, 565
- Алиев Г. М., см. Мехтиев Н. М. 10, 1882
- Алмазов Л. А., Малютенко В. К., Федоренко Л. Л. Бесконтактный метод определения коэффициента биполярной диффузии неравновесных носителей заряда в полупроводниках. 8, 1337
- Алфёров Ж. И., Андреев В. М., Аксенов В. Ю., Ларионов В. Р., Румянцев В. Д., Хвостиков В. П. Квантово-размерные виакопоровые AlGaAs-гетеролазеры, полученные методом низкотемпературной жидкофазной эпитаксии. 10, 1775
- Алфёров Ж. И., Антонишкис Н. Ю., Арсентьев И. Н., Гарбузов Д. З., Колышкин В. И., Налет Т. А., Стругов Н. А., Тихунов А. В. Квантово-размерные InGaAsP/GaAs ( $\lambda=0.86-0.78$  мкм) лазеры с разделением ограничений ( $J_p=100$  А/см<sup>2</sup>, КПД=59%). 6, 1031
- Алфёров Ж. И., Гарбузов Д. З., Денисов А. Г., Евтихийев В. П., Комиссаров А. Б., Сеичкин А. П., Скороходов В. Н., Токранов В. Е. Квантово-размерные AlGaAs/GaAs-гетероструктуры со 100%-м квантовым выходом излучательной рекомбинации, полученные методом молекулярно-пучковой эпитаксии. 12, 2105
- Алфёров Ж. И., Гарбузов Д. З., Жигулин С. Н., Кузьмин И. А., Орлов Б. Б., Синицын М. А., Стругов Н. А., Токранов В. Е., Явич Б. С. Квантово-размерные лазерные AlGaAs/GaAs-гетероструктуры, полученные МОС гидридным методом. Квантовый выход люминесценции и пороги генерации. 12, 2111
- Амбразевичус Г., см. Марцинкявичюс С. 11, 1919
- Амусья В. М., Бирюлин Ю. Ф., Воробьева В. В., Голубев Л. В., Новиков С. В., Чалдышев В. В., Шмарцев Ю. В. Зависимость ширины запрещенной зоны от состава в твердом растворе InP<sub>1-x</sub>Sb<sub>x</sub> ( $x \leq 0.07$ ). 2, 342
- Андреев А. А., см. Стриха В. И. 3, 461
- Андреев А. Г., см. Алексеев М. В. 1, 140
- Андреев В. М., Гусинский Г. М., Калинин В. С., Салиева О. К., Соловьев В. А., Сулима О. В., Хаммедов А. М. Влияние радиации на фотоэлектрические параметры AlGaAs-(p-n)-GaAs-гетероструктур. 8, 1391
- Андреев В. М., Еремин В. К., Строкан Н. Б. Переходный ток, ограниченный объемным зарядом, в недообеденных структурах с блокирующими контактами. 6, 1096
- Андреев В. М., Еремин В. К., Строкан Н. Б. Изменение градиента концентрации лития при компенсации полупроводников методом дрейфа ионов. 8, 1526
- Андреев В. М., Еремин В. К., Строкан Н. Б. Диффузионные процессы в пакете носителей, дрейфующих в поле p-n-перехода. 9, 1629
- Андреев В. М., Еремин В. К., Строкан Н. Б., Шокина Е. В. Определение профиля концентрации лития при его дрейфе в кремнии по емкостным измерениям. 11, 2039
- Андреев В. М., см. Алфёров Ж. И. 10, 1775
- Андреев П. А., см. Регель А. Р. 10, 1856
- Андрианов Д. Г., Белоконов С. А., Климонский С. О., Лакеенков В. М. Осцилляции Шубникова-де-Гааза в Pb<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>Te. 4, 670

\* Статьи, отмеченные звездочкой, депонированы в ЦНИИ «Электроника».

- Андриеш А. М., Акимова Е. А., Берил С. И., Верлан В. И. Инжекция и перенос дырок в гетероструктуре  $\text{Se}/\text{As}_2\text{Se}_3$ . 2, 289
- Андроник К. И., Бойко М. П., Лужковский А. В. Влияние примесной полосы таллия на магнитную восприимчивость теллурида свинца. 10, 1878
- Андрюшко А. И., Салихов Х. М., Слободчиков С. В. Поверхностно-барьерные структуры  $\text{Au}-p\text{-InAs}_{1-x-y}\text{Sb}_x\text{P}_y$ . 8, 1528
- Андрюшко А. И., Салихов Х. М., Слободчиков С. В., Стусь Н. М., Талалакин Г. Н. О механизмах рекомбинации носителей тока в  $p\text{-InAs}_{1-x-y}\text{Sb}_x\text{P}_y$ . 5, 789
- Аникин М. М., Лебедев А. А., Попов И. В., Пятко С. Н., Растегаев В. П., Сыркин А. Л., Царенков Б. В., Челноков В. Е. Электростатические свойства  $\text{SiC-6H}$ -структур с резким  $p-n$ -переходом. 1, 133
- Аникин М. М., Лебедев А. А., Попов И. В., Растегаев В. П., Стрельчук А. М., Сыркин А. Л., Таиров Ю. М., Цветков В. Ф., Челноков В. Е. Электрические характеристики эпитаксиальных  $p^+-n-n^+$ -структур на основе карбида кремния политипа 6H. 2, 298
- Аникин М. М., Левинштейн М. Е., Попов И. В., Растегаев В. П., Стрельчук А. М., Сыркин А. Л. Температурная зависимость напряжения лавинного пробоя в карбид-кремниевых  $p-n$ -переходах. 9, 1574
- Анисимова Н. П., Глобус Т. Р., Олеск С. А. Скорость поверхностной рекомбинации в поликристаллических слоях селенида свинца. 9, 1590
- Антоненко А. Х., Болотов В. В., Двореченский А. В., Ступинский В. А., Харченко В. А., Стук А. А. Накопление и отжиг радиационных дефектов в кремнии в зависимости от температуры при облучении нейтронами. 5, 887
- Антоненко В. И., Ждан А. Г., Сульженко П. С. Термоактивационный анализ плотности пограничных состояний и энергетической зависимости сечений захвата в  $\text{Si-MOP}$  структурах. 2, 223
- Антоненко В. И., Ждан А. Г., Сульженко П. С. Идентификация пространственной локализации пограничных состояний в экспериментах по термостимулированному разряду МДП конденсатора. 4, 758
- Антонишин Н. Ю., см. Алфёров Ж. И. 6, 1031
- Антонова И. В., Васильев А. В., Панов В. И., Шаймеев С. С. Применение емкостной методики DLTS к исследованию полупроводников с неоднородным распределением примесей (дефектов). 6, 998
- Антонова И. В., см. Аёшин А. И. 4, 692
- Антюшин В. Ф., Сысоев В. И. Об определении поверхностной подвижности зарядов в инверсионном слое резистивно-емкостной МДП структуры с распределенными параметрами. 5, 902
- Антюшин В. Ф., см. Сысоев В. И. 10, 1871
- Арапов Ю. Г., Давыдов А. Б., Зверева М. Л., Штрагенин Г. Л. Влияние примесных дырок на диэлектрическую проницаемость бесщелевых полупроводников. 5, 893
- Арешев И. П., Розанов Н. Н., Субашиев В. К., Фараджев Б. Г., Ходова Г. В. Динамический гистерезис профиля пучка света в плоскопараллельных пластинках  $n\text{-InP}$ . 6, 1068
- Арешев И. П., Субашиев В. К., Фараджев Б. Г. Линейно-циркулярный дихроизм двухфотонного поглощения и самодефокусировка излучения неодимового лазера в кристаллах  $n\text{-InP}$ . 2, 325
- Арзамасцев А. П., Данилин А. Б. Атермическая роль скорости набора дозы в кинетике дефектообразования при имплантации ионов фосфора в кремний. 11, 2063
- Аронзон Б. А., Никитин М. С., Сусов Е. В., Чумаков Н. К. О природе индуцированного магнитным полем перехода металл-диэлектрик в  $n\text{-Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$ . 5, 897
- Аронов Д. А., Кабулов Р., Юабов Ю. М., Ягудаев Д. А. Токовые характеристики  $p-i-n$ - и  $p^+-i-p^+$ -структур на основе гидрированного аморфного кремния при различных температурах и уровнях фотовозбуждения.\* 9, 1719
- Арсентьев И. Н., см. Алфёров Ж. И. 6, 1031
- Арсеньев В. Г., Богданкевич О. В., Зверев М. М., Копыт С. П., Кудяров Ю. А. Методика лазерного катодопоглощения. 8, 1401
- Артамонов В. В., Валах М. Я., Лисица М. П., Литовченко В. Г., Романюк Б. Н., Рудской И. В., Стрельчук В. В. Исследование процесса разупорядочения кремния при ионной имплантации  $\text{Ag}^+$ . 11, 1961
- Артамонов О. М., Дмитриева О. Г., Самарин С. П., Яковлев И. И. Низкоэнергетические изохроматные спектры кремния. 4, 638
- Артемова А. А., см. Земсков Б. Г. 5, 934
- Артемов В. А., Михнович В. В. О влиянии деформации на электростатический потенциал областей разупорядочения в полупроводниках. 2, 243
- Артемов В. А., Михнович В. В. Механические напряжения и пьезопотенциал областей разупорядочения в полупроводниках кубической симметрии.\* 5, 953
- Артемов В. А., Михнович В. В. Механические напряжения и флексоэлектрический потенциал областей разупорядочения в полупроводниках кубической симметрии.\* 5, 954
- Артемов В. А., Михнович В. В. О диффузионно-контролируемых скоростях реакций радиационного дефектообразования в полупроводниках.\* 5, 955
- Артемов В. А., Михнович В. В., Тятаренко С. Г. Модель кинетики формирования областей разупорядочения

- в полупроводниках с учетом деформаций. 4, 750
- Арушанов Э. К., Губанова А. А., Князев А. Ф., Лашкул А. В., Лисунов К. Г., Сологуб В. В. Циклотронные массы и  $g^*$ -факторы электронов в твердых растворах арсенид кадмия—арсенид цинка. 2, 338
- Архипов В. И., Казакова Л. П., Лебедев Э. А., Руденко А. И. Пространственное распределение плотности носителей заряда при дрейфе в стеклообразном  $As_2Se_3$ . 4, 723
- Архипов В. И., Логин В. М., Руденко А. И., Симашкевич А. А., Шутов С. Д. Формирование активационного барьера на контакте металл—аморфный полупроводник. 2, 276
- Архипов В. И., Никитенко В. Р. Кинетика близнецовой рекомбинации в аморфных материалах в условиях поверхностной генерации пар. 3, 419
- Архипов В. И., Никитенко В. Р., Руденко А. И. Неравновесный фотоэлектрический эффект в неупорядоченных материалах. 3, 544
- Асадов Ю. Г., см. Гусейнов Д. Т. 5, 956
- Аскаров Ш. И., см. Бахадырханов М. К. 9, 1716
- Аскеров В. М., Гашимазде Н. Ф., Кулиев Б. И., Панахов М. М. Недиссипативные термомагнитные явления в полупроводниковых сверхрешетках в квантующем магнитном поле. 6, 1104
- Асрян Л. В., Шика А. Я. Обратный ток и фототок  $p-n$ -перехода с высокой концентрацией рекомбинационных центров. 4, 613
- Асрян Л. В., Шика А. Я. Захват неравновесных носителей и кинетика фотоотклика в  $p-n$ -переходах. 12, 2199
- Астров Ю. А., Порцель Л. М. Урбатовский характер спектров примесного оптического поглощения полупроводника за счет кулоновского взаимодействия центров. 4, 679
- Атакулов Б. А., Журкин Б. Г., Убайдуллаев М. И. Исследование физических свойств тензочувствительных пленок  $(BiSb)_2Te_3$  под действием лазерного облучения (ЛЮ). 3, 530
- Атакулов Ш. Б., Гафуров У. А., Казьмин С. А. О межзонном рассеянии дырок в теллуриде висмута сурьмы. 3, 539
- Афанасьева Л. А., см. Житинская М. К. 11, 2043
- Афонин О. Ф., Викторов Б. В., Забродин Б. В., Козловский В. В., Марущак Н. В., Шустов Б. А. Трансмутационное легирование арсенида галлия при облучении протонами и альфа-частицами. 1, 56
- Ахметов В. Д., Болотов В. В. Поведение примесей бора и фосфора в кремнии при облучении нейтронами и последующих отжигах. 9, 1556
- Бабаев А. А., Теруков Е. И., Шведков И. В. О глубоких центрах фотолюминесценции в легированных ХСП и  $a-Si$ :H. 5, 927
- Бабичкий Ю. М., Горбачева Н. И., Гринштейн П. М., Ильин М. А., Кузнецов В. П., Мильвидский М. Г., Туровский Б. М. Кинетика генерации низкотемпературных кислородных доноров в кремнии с изовалентными примесями. 2, 307
- Бабич В. М., Баран Н. П., Бугай А. А., Кончиц А. А., Ковальчук В. Б., Максименко В. М., Шанина Б. Д. Электрические и парамагнитные свойства термодоноров-II в кремнии. Обсуждение модели.\* 5, 956
- Бадалян С. М., Левинсон И. Б. Циклотрон-фононный резонанс в двумерном электронном газе. 11, 2019
- Баженов В. К., Кардашев Д. Л., Нахабин А. В. Электронные состояния одиночных вакансий в ZnSe и CdTe. 1, 179
- Баженов Н. Л., Гасанов С. И., Иванов - Омский В. И., Мынбаев К. Д., Огородников В. К., Процык В. И. Туннельно-рекомбинационные токи в  $p-n$ -переходах на основе  $Cd_{1-x}Hg_xTe$  при  $T > 80$  К. 2, 333
- Баженов Н. Л., Иванов - Омский В. И., Миронов К. Е., Мовилев В. Ф. Электрические свойства эпитаксиальных слоев  $Mn_xCd_yHg_{1-x-y}Te$ . 7, 1258
- Базулевич Ю. Ю., Гретчел Р., Кагадей В. А., Лебедева Н. И., Проскуровский Д. И., Янкевич Е. Б. Поведение мышьяка в ионно-легированном слое кремния при нагреве электронным пучком секундной длительности.\* 12, 2245
- Байрамов А. И., Джафаров Т. Д., Новрузов В. Д. Влияние диффузии и взаимодействия примесей I группы с вакансиями на свойства  $CdS$ .\* 9, 1716
- Байрамов М. А., Веденев А. С., Волков Л. В., Ждан А. Г. Проявление флуктуационного потенциала в кинетических характеристиках  $n$ -каналов инверсии на поверхности кремния. Случай малых флуктуаций. 8, 1365
- Бакуева Л. Г., Захарова И. Б., Ильин В. И., Мухихин С. Ф. Электрические и фотоэлектрические свойства пленок  $Pb_{1-x}Sn_xS(Na)$ . 10, 1896
- Бакуева Л. Г., Ильин В. И., Мухихин С. Ф. Контакт алюминия с фоточувствительной пленкой сульфида свинца. 8, 1495
- Бакши И. С., Кодалашвили М. З., Сальков Е. А., Хижняк Б. И.  $1/f$ -шум ЭДС Холла в  $n-Cd_xHg_{1-x}Te$ . 12, 2182
- Балагуров Л. А., Омельяновский Э. М., Осташко С. А., Стариков М. Н., Стыс Л. Е. Особенности стационарной фотопроводимости аморфного гидрогенизированного кремния. 1, 168
- Балагуров Л. А., Омельяновский Э. М., Пивскер Т. Н., Примбетов К. К., Уткин - Эдин Д. П. Исследование спектра локальных состояний  $a-Si$ :H методом фотоэлектрической релаксационной спектроскопии. 1, 155
- Балагуров Л. А., Омельяновский Э. М., Примбетов К. К., Стариков М. Н. Энергетический спектр локализованных  $D$ -состояний в легированных образцах  $a-Si$ :H. 11, 1967

- Балмуш И. И., Дашевский З. М., Касиан А. И. Термоэлектрические свойства  $p-n-p$ ... структуры.\* 12, 2243
- Балтрамеюнас Р., Велецкас Д. Влияние мелких примесей на дефокусировку лазерного луча в кристаллах кремния. 1, 146
- Балтрамеюнас Р., Гаврюшин В., Рачюкайтис Г., Рыжиков В., Казлаускас А., Кубертавичюс В. Спектроскопия глубоких центров в монокристаллах ZnSe:Te методом лазерной модуляции двухступенчатого поглощения. 7, 1163
- Балтрамеюнас Р., Гашка Р., Курокшис Э., Нятикшис В., Пятраускас М. Пикосекундная релаксация поверхностных динамических решеток в имплантированных и импульсно-отожженных кристаллах кремния. 8, 1422
- Балтрамеюнас Р., см. Вайнерт Х. 12, 2232
- Бальчюнас В. Ч., см. Чеснис А. А. 6, 1132
- Баран Н. П., см. Бабич В. М. 5, 956
- Баранова Е. К., см. Александров П. А. 4, 731
- Барановский С. Д., Гельмонт Б. Л., ДеАндрадэ Силва Е. А., ДаКунья Лима И. К. Квадрупольное уширение спектральных линий водородоподобных примесей в слабо легированных компенсированных полупроводниках. 9, 1585
- Баранский П. И., Беляев А. Е., Городничий О. П., Макаренко В. Г. Влияние иттербия на электрофизические свойства эпитаксиальных слоев  $n$ -GaP. 1, 158
- Баранский П. И., Соколюк Д. В., Торшней В. И., Чипенко Г. В. Особенности рассеяния дырок в синтетических алмазах в греющих электрических полях. 11, 2069
- Баранский П. И., Торшней В. И., Чипенко Г. В. О прыжковой проводимости в полупроводниковом алмазе. 12, 2214
- Баранский П. И., см. Буда И. С. 2, 355
- Баранюк В. Б., Комиссаров Г. П., Манассон В. А., Шустер Э. М. Эффект усиления фототока в гетероструктуре  $\text{In}_2\text{O}_3-\alpha\text{-Si}:\text{H}-\text{Si}$  4, 733
- Барбашов М. Н., см. Мастеров В. Ф. 4, 654
- Барейкис В., Билькис Ж., Либерис Ю., Сакалас П., Шальтис Р. Шумы и диффузия в коротких  $n^+-n-n^+$ - $\text{InP}$ -структурах. 6, 1040
- Батунина А. В., Воронков В. В., Воронкова Г. И., Калинушкин В. П., Мурина Т. М., Фирсов В. И., Шулепников М. Н. Влияние быстродиффундирующих примесей на малоугловое рассеяние света в кремнии. 7, 1308
- Бахадырханов М. К., Абдураимов А., Илев Х. М. Распад твердого раствора  $\text{Si}(\text{Mn})$  при всестороннем гидростатическом сжатии. 1, 123
- Бахадырханов М. К., Зикрилдаев Н. Ф., Турсунов А. А., Аскаров Ш. И. Неустойчивость инжекционного тока в кремнии, легированном марганцем.\* 9, 1716
- Бахтиярова М. В., см. Смирнов И. Н. 2, 357
- Башпиров Р. И., Гавриленко В. И., Красильник З. Ф., Мусаев А. М., Никоноров В. В., Потапенко С. Ю., Чернобровцева М. Д. Междозонные оптические переходы горячих дырок в одноосно деформированном германии. 3, 479
- Баязитов Р. М., Ивлев Г. Д., Хайбуллин И. Б., Малевич В. Л., Саинов Н. А. Модификация структуры и электрическая активация примеси при наносекундном лазерном ожиге имплантированного кремния. 1, 79
- Беда А. Г., Воробкало Ф. М., Вайнберг В. В., Зарубин Л. И., Лазебник И. М., Овчаров В. В. Влияние резонансных нейтронов на характеристики трансмутационно легированного германия. 11, 2065
- Бекимбетов Р. Н., Рудь Ю. В., Таиров М. А., Ундалов Ю. К., Ушакова Т. Н., Войко М. Е. Дихроизм кристаллов  $\text{MnIn}_2\text{Te}_4$  и фотоплеохроизм структур на их основе. 6, 1101
- Бекимбетов Р. Н., см. Марцинявичюс С. 11, 1919
- Белобородов П. Ю., Толбанов О. П., Хлудков С. С. Влияние процессов перезарядки глубоких центров на задержку пробоя арсенид-галлиевых  $n-v-n$ -структур, компенсированных железом. 4, 755
- Белоков С. А., см. Андрианов Д. Г. 4, 670
- Беляев А. Е., Городничий О. П., Семенов Ю. Г., Шевченко Н. В., Боднарчук О. А., Раренко И. М. Особенности осцилляций Шубникова-де-Гааза в  $\text{Mn}_{0.11}\text{Hg}_{0.89}\text{Te}$ . 2, 335
- Беляев А. Е., см. Баранский П. И. 1, 158
- Беляков Л. В., Горобей Н. Н., Горячев Д. Н., Сресели О. М., Ярошецкий И. Д. Влияние распределения поля поверхностного поляритона в системе диэлектрик-металл-полупроводник на фотоответ полупроводника. 5, 906
- Берил С. И., см. Андриеш А. М. 2, 289
- Берковиц В. Л., Кяселев В. А., Минашвили Т. А., Сафаров В. И. Оптическое исследование закрепления уровня Ферми на поверхности (110) полупроводниковых соединений АШВУ. 1, 66
- Берковская Ю. Ф., Гельмонт Б. Л., Цидильковский Э. И. Свободный магнитный полярон в полупроводниках с вырожденной зоной. 5, 855
- Берман Л. С. Исследование объемных глубоких центров со сплошным энергетическим спектром методом двойной изотермической релаксации емкости (теория).\* 9, 1717
- Берман Л. С., Мальяренко А. М., Ременко А. Д., Суханов В. Л., Толстобров М. Г. Распределение радиационных дефектов и физическая

- природа «аномальных» спектров DLTS в кремниевых диодах, облученных  $\alpha$ -частицами. 5, 844
- Берман Л. С., Ременюк А. Д., Толстобров М. Г. Термоионизация Е-центров в кремнии, ускоренная электрическим полем, и особенности идентификации глубоких центров в низкоомных полупроводниках. 12, 2169
- Билпенец Ю. Ю., см. Малютенко В. К. 4, 593
- Бильгильдеева Т. Ю., Каряев В. Н., Полянская Т. А. Слабая локализация и спин-орбитальное взаимодействие в твердом растворе  $\text{GaAs}_{0.94}\text{Sb}_{0.06}$  р-типа. 3, 381
- Билькис Ж., см. Барейкис В. 6, 1040
- Бпрюлин Ю. Ф., см. Амусья В. М. 2, 342
- Блецкан Н. И., Кузнецов В. И., Лукаков П. Ф., Салманов А. Р., Цикунев А. В. Особенности образования радиационных дефектов в кремнии, легированном гадолинием. 12, 2223
- Бобрикова О. В., Герасименко Н. Н., Стась В. Ф. Влияние интенсивности облучения электронами на накопление А-центров в области пространственного заряда в кремнии. 12, 2236
- Бобрикова О. В., Стась В. Ф. Влияние электрического поля на накопление А-, Е-центров в кремнии. 1, 143
- Бобровников Ю. А., Казакова В. М., Фистуль В. И. Квантовый гармонический резонанс в кремнии. 2, 301
- Богданкевич О. В., см. Арсеньев В. Г. 8, 1401
- Богданов Е. В., Лавренюк М. Ю., Мпвина Н. Я. Деформационные потенциалы запрещенной зоны у полупроводникового сплава  $\text{V}_{10}\text{Sb}_{10}$  и определение прямых энергетических щелей с помощью резонансной ударной ионизации. 8, 1348
- Богданов С. В., Губанов В. А. Многоокислотно-примесные комплексы в 6H-SiC. 4, 728
- Боднарук О. А., см. Беляев А. Е. 2, 335
- Бойко М. Е., см. Бекимбетов Р. Н. 6, 1101
- Бойко М. П., см. Андроник К. И. 10, 1878
- Болд З., Казанский А. Г., Климашин И. В., Миличевич Е. П., Теруков Е. И. Влияние энергии возбуждения на температурное гашение фотопроводимости в аморфном гидрогенизированном кремнии. 12, 2173
- Болотов В. В., Камаев Г. Н., Смирнов Л. С. ИК спектроскопические исследования взаимодействия фосфора с радиационными дефектами в кремнии при облучении электронами. 2, 210
- Болотов В. В., Карпов А. В., Стучинский В. А. Влияние дрейфа вакансий в электрическом поле на формирование распределения радиационных дефектов вблизи границ раздела в кремнии. 1, 49
- Болотов В. В., Стучинский В. А. Определение характерных времен формирования неоднородного профиля вакансионных дефектов в кремнии у границы раздела под действием электрического поля. 8, 1405
- Болотов В. В., см. Антоненко А. Х. 5, 887
- Болотов В. В., см. Ахметов В. Д. 9, 1556
- Борблик В. Л., Грибников З. С. Транзисторы на горячих электронах (обзор). 9, 1537
- Бордюжа Л. П., см. Захаров Ю. В. 3, 485
- Борис Тимофеевич Коломиец (к 80-летию со дня рождения). 9, 1721
- Бородин О. М., см. Омельяновский Э. М. 7, 1203
- Бородин О. М., см. Омельяновский Э. М. 12, 2217
- Бородовский П. А., Булдыгин А. Ф. Эффект остаточной ЭДС при СВЧ пробое арсенида индия. 3, 489
- Борщак В. А., Василевский Д. Л., Виноградов М. С., Сердюк В. В. Определение диффузионной длины неосновных носителей в неидеальных гетеропереходах. 3, 561
- Бочкарев В. В., Седлецкий О. А. Рекомбинация фотовозбужденных носителей тока в селениде цинка с остаточной проводимостью.\* 5, 960
- Бочкарева Л. В., Зимин С. П. Концентрационная зависимость коэффициента термоэдс эпитаксиальных пленок  $\text{Pb}_{0.8}\text{Sn}_{0.2}\text{Te}$ . 4, 675
- Бочков А. В., Машкевич О. Л. Нелинейная теория аномальных температурных полей в твердых телах. 4, 764
- Бочков В. С., Гредескул Т. С., Гуревич Ю. Г. Неравновесные электроны и фононы в полупроводниках конечных размеров в электрических полях. 3, 396
- Бразис Р. С., Кунггелис А. А. Одночастотный режим вынужденного излучения в кристаллах р-Ge в полях  $E_0 \parallel V_0 \ll \langle 100 \rangle$ . 9, 1614
- Бразис Р. С., Мишкин С. Р. А., Рутковский П. Ф. Возбуждение акустической волны в n-InSb отражающимся СВЧ электромагнитным излучением. 9, 1689
- Бразис Р. С., Сафонова Л. С. Распространение электромагнитных волн вдоль слоев периодической структуры полупроводник-диэлектрик с учетом гиротропии. 2, 320
- Брайтштайн О., Конончук О. В., Панин Г. Н., Хайденрайх Й., Якимов Е. Б. Исследование теллурида кадмия методом сканирующей спектроскопии глубоких уровней. 9, 1687
- Брандт Н. Б., Доропей В. Н., Дубков В. П., Скипетров Е. П. Зона локальных состояний в сплаве  $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Se}$  ( $x=0.125$ ), облученном электронами. I. Гальваномагнитные явления под давлением. 8, 1462
- Брандт Н. Б., Доропей В. Н., Дубков В. П., Скипетров Е. П. Зона локальных состояний в сплаве  $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Se}$  ( $x=0.125$ ), облученном электронами. II. Структура локальной зоны. 8, 1469
- Брандт Н. Б., Ковалюк З. Д., Кульбачинский В. А. Фотопроводимость в слоистых кристаллах InSe. 9, 1657
- Брандт Н. Б., см. Матвеев Г. А. 5, 799

- Бородовой А. В., см. Лашкарев Г. В. 4, 766
- Брудный В. Н., Пешев В. В., Прилулов А. М. Накопление  $E3$ -центров в  $n$ -GaAs при  $\gamma$ -облучении в интервале температур 77—580 К. 6, 1124
- Брук А. С., Говоркова А. В., Мильвудский М. Г., Попова Е. В., Шленский А. А. Влияние легирующих примесей на формирование переходных слоев в эпитаксиальных структурах арсенида галлия. 10, 1792
- Брук А. С., см. Омеляновский Э. М. 7, 1203
- Бугай А. А., см. Бабич В. М. 5, 956
- Буда И. С., Баранский П. И. Тензор Нернста—Эттинггаузена в одноосно деформированных полупроводниках в условиях электрон-фононного увлечения. 2, 355
- Буда И. С., Охрем Е. А. Электрические свойства одноосно деформированных кристаллов твердого раствора Ge—Si  $n$ -типа.\* 5, 957
- Булдыгин А. Ф., см. Бородовский П. А. 3, 489
- Бумялене С. Усиление малого сигнала в возбужденном  $n$ -Ge(Ni) в условиях возникновения умножения периода. 2, 328
- Буртыка М. В., Ханкина С. И., Яковенко В. М. Взаимодействие поверхностных плазмонов и волн пространственного заряда в структуре полупроводник—диэлектрик—полупроводник.\* 9, 1718
- Бурторин О. В., Казанский А. Г. Исследование дрейфовой подвижности электронов в аморфном гидрогенизированном кремнии методом нестационарной фотопроводимости. 1, 84
- Бутько В. Г., Гусев А. А. Безынерционная поляризация валентного полупроводника локализованным электронным возбуждением. 6, 1139
- Бушуева Г. В., Решетов В. И., Хромов А. А., Пендюров С. А., Насибов А. С., Печенов А. Н. Влияние легирования кислородом на дефектную структуру и спектры люминесценции кристаллов CdS. 2, 201
- Быков А. А., Кwon З. Д., Ольшанецкий Е. Б. Плотность состояний двумерного электронного газа в одномерной сверхрешетке. 9, 1706
- Быковский В. А., Долгих Н. И., Емцев В. В. Роль остаточных технологических примесей в образовании излучательной рекомбинации в облученном германии.\* 5, 960
- Быковский В. А., см. Акулович Н. И. 9, 1720
- Вавилов В. С., см. Пономарев В. Н. 9, 1563
- Вайнберг В. В., см. Беда А. Г. 11, 2065
- Вайнерт Х., Латинский В., Юршенас С., Балтрамеюнас Р. Исследования экситонной люминесценции сверхрешеток GaAs—GaAlAs с пикосекундным временным разрешением. 12, 2232
- Вайнштейн С. Н., Жилев Ю. В., Левинштейн М. Е. Исследование субнаносекундного включения арсенид-галлиевых тиристорных структур. 6, 1134
- Ваксер А. И. Неустойчивость холодных электронов в полупроводниках. 8, 1520
- Валах М. Я., см. Артамонов В. В. 11, 1961
- Валдатс Г. А., Кирсон Я. Э., Клотыньш Э. Э. Холловская подвижность в арсениде галлия с прямой линейной несодородностью.\* 9, 1717
- Ванем Р. А., Кикоин К. А., Лыук П. А., Первова Л. Я. Оптические свойства двойных дефектов в GaAs:Cr 2, 255
- Васецкий В. М., Порошин В. Н., Сарбей О. Г., Саркисян Э. С. Нелинейное поглощение ИК излучения в диричном германии при низких температурах. 9, 1610
- Василевский Д. Л., см. Борщак В. А. 3, 561
- Васильев А. В., Михнович В. В., Смагулова С. А. Механизм отжига разупорядоченных областей в кремнии. 6, 1137
- Васильев А. В., см. Айшин А. И. 4, 692
- Васильев А. В., см. Антонова И. В. 6, 998
- Васильев А. Л., см. Индаев Е. В. 7, 1190
- Васильев А. Э., Ильин Н. П., Мастеров В. Ф. Спин-поляризованный расчет электронной структуры примесей переходных элементов в полупроводниках. Марганец и железо в арсениде галлия. 7, 1253
- Васин О. И., Климов А. Э., Ненавственный И. Г., Петиков Н. И., Филатова Е. С., Шумский В. Н. Время жизни неравновесных носителей заряда в объеме и рекомбинация на границах в пленках  $Pb_{0.8}Sn_{0.2}Te$  на  $BaF_2$ . 7, 1299
- Ватаманюк П. П., см. Савчук А. И. 3, 512
- Веденеев А. С., Воронкова Г. И., Ждан А. Г., Коган Ш. М., Ляфшиц Т. М., Рыльков В. В. Определение концентраций остаточных примесей в легированных слабокомпенсированных полупроводниках. 4, 586
- Веденеев А. С., Гольдман Е. И., Ждан А. Г., Савостьянов А. В. Динамическая релаксационная спектроскопия — определение параметров локализованных электронных состояний в режиме периодической термостимуляции. 7, 1199
- Веденеев А. С., см. Байрамов М. А. 8, 1365
- Веденеев С. И., Георгобяни А. Н., Левит А. Д., Рамбиди Н. Г., Тодуа П. А., Шестакова Е. Ф., Эльтазаров Б. Т. Излучательные и электрофизические свойства МДП структур на основе CdS и легированной пленки. 5, 936
- Вейнгер А. И.  $N$ -образность ВАХ кремниевых  $p$ - $n$ -переходов в сильных СВЧ полях. 11, 1972
- Вейнгер А. И., см. Аблязимова Н. А. 11, 2001
- Вейс А. Н., Гриневич А. В., Кайданов В. И., Мельник Р. Б., Немов С. А. Электрофизические и оптические свойства  $p$ -PbTe(Ag). 1, 174

- Вейс А. Н., Кайданов В. И., Крупичкая Р. Ю. Резонансные уровни в сильно компенсированном  $p$ -PbTe по данным ИК поглощения. 2, 349
- Вейс А. Н., Крупичкая Р. Ю., Лумер А. В. Резонансные состояния, связанные с вакансиями халькогена, в электронном сульфиде свинца. 8, 1514
- Велецкас Д., см. Балтрамеюнас Р. 1, 146
- Веренчикова Р. Г., Санкин В. И. Влияние термического отжига на свойства барьеров Шоттки  $\text{Cr-SiC}$   $n$ - и  $p$ -типа электропроводности. 9, 1692
- Веретин В. С., Мансфельд Г. Д. Циклотронная акустоэлектронная генерация в  $n$ -InSb в «бесстолкновительном» режиме взаимодействия. 11, 1924
- Верлан В. И., см. Андриеш А. М. 2, 289
- Викторов Б. В., см. Афонин О. Ф. 1, 56
- Викзулин И. М., см. Курмашев Ш. Д. 12, 2244
- Вильмс П. П., Энтин М. В. Квантовые ямы, обусловленные неоднородным магнитным полем. 11, 1905
- Винников А. Я., Мешков А. М., Титков А. С. Частотная дисперсия электропроводности неупорядоченного поликристаллического полупроводника в сильном переменном электрическом поле. 3, 390
- Виноградов М. С., см. Борщак В. А. 3, 561
- Винокуров Л. А., Фукс Б. И. Растекание тока в фоточувствительной среде с примесной фотопроводимостью. 11, 1986
- Винокурова А. В., см. Копьев П. С. 3, 424
- Вирт И. С., Григорьев Н. Н., Любченко А. В. Ограничение времени жизни сферических дефектами структуры в фоточувствительных полупроводниках. 3, 409
- Витовский Н. А., Емцев В. В., Машовец Г. В., Полоскин Д. С. Эффективность взаимодействия вакансий с донорами V группы в  $n$ -германии. 8, 1483
- Витовский Н. А., Налбандян Л. В., Полоскин Д. С. Приповерхностные слои с квазиметаллической проводимостью в германии, подвергнутом гамма-облучению при 4.2 К. 7, 1316
- Витовский Н. А., см. Емцев В. В. 5, 924
- Витусевич С. А., см. Аюпян А. А. 3, 471
- Вишневская Б. И., Дмитриев В. А., Коваленко И. Д., Коган Л. М., Морозенко Я. В., Родкин В. С., Сыркин А. Л., Царенков Б. В., Челноков В. Е. Синие  $\text{SiC-6H}$ -светодиоды. 4, 664
- Воеводин Е. И., Гершензон Е. М., Гольцман Г. Н., Птицина Н. Г., Чулкова Г. М. Захват свободных дырок заряженными акцепторами в одноосно деформированном Ge. 3, 540
- Войцеховский А. В., Кирюшкин Е. М., Лиленко Ю. В., Петров А. С., Черников Е. В., Кузнецов Н. В., Курбанов К. Р., Мамонтов А. П. Ускоренная диффузия индия в  $\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$  под воздействием облучения ионами при  $T=300$  К. 12, 2226
- Волков Л. В., см. Байрамов М. А. 8, 1365
- Воробкало Ф. М., см. Беда А. Г. 11, 2065
- Воробьева В. В., см. Амусья В. М. 2, 342
- Воронина Т. И., Дахно А. Н., Емельяненко О. В., Лагунова Т. С., Старосельцева С. П. Примесная проводимость в  $n$ -GaAs и  $n$ -InP на металлической стороне перехода металл-диэлектрик. 7, 1230
- Воронина Т. И., Емельяненко О. В., Дахно А. Н., Лагунова Т. С., Старосельцева С. П., Чугуева З. И. Релаксация фазы и локализация электронов в  $n$ -GaAs и  $n$ -InP вблизи перехода металл-диэлектрик. 6, 1129
- Воронина Т. И., Лагунова Т. С., Саморуков Б. Е., Стругов Н. А. Свойства эпитаксиальных слоев арсенида галлия, легированных редкоземельными элементами. 1, 147
- Воронков В. В., см. Батунина А. В. 7, 1308
- Воронкова Г. И., см. Батунина А. В. 7, 1308
- Воронкова Г. И., см. Веденев А. С. 4, 586
- Второе информационное сообщение. 3, 563
- Выжигин Ю. В., Грессеров Б. Н., Соболев Н. А. Исследование влияния глубоких уровней на микроплазменный пробой  $p$ - $n$ -переходов. 3, 536
- Вязьмитинов И. А., см. Шеховцов Н. А. 5, 958
- Гавалешко Н. П., см. Исмаилов Ж. Т. 3, 375
- Гавриленко В. И., Додин Е. П., Красильник З. Ф., Никоиоров В. В., Чернобровцева М. Д. Циклотронный резонанс горячих дырок германия. 7, 1233
- Гавриленко В. И., Ключ Н. И., Литовченко В. Г., Стрельницкий В. Е. Электроотражение аморфного гидрогенизированного углерода. 7, 1302
- Гавриленко В. И., см. Баширов Р. И. 3, 479
- Гаврюшин В., см. Балтрамеюнас Р. 7, 1163
- Галванаскас А., Гореленок А., Добровольскис З., Кершулис С., Пожеда Ю., Реклайтис А., Шмидт Н. Явления переноса и сплавное рассеяние в соединениях  $\text{In}_{1-x}\text{Ga}_x\text{As}_y\text{P}_{1-y}$ . 9, 1672
- Галкин М. Г., Курбатов В. А., Соловьев Н. Н. Влияние концентрации примеси на сечение ее фотоионизации (ион  $\text{Zn}^+$  в германии). 6, 1122
- Галченков Л. А., Гродненский И. М., Костовецкий М. В., Матов О. Р., Медведев Б. А., Мокеров В. Г. Резонансный эффект Фарадея в ограниченной двумерной электронной системе. 7, 1196
- Гальперин Ю. М., Пардаев А. П. О поглощении звука свободными носи-



- телями в слабо легированных компенсированных полупроводниках. 5, 915
- Гальперин Ю. М., Приев Э. Я. Неомические эффекты в ВЧ прыжковой проводимости. 3, 493
- Гантмахер В. Ф., Зверев В. Н., Шовкун Д. В. О механизме магнитопримесных резонансов в фотовозбужденном  $p$ -Ge. 4, 575
- Гарасько Г. И., Урюпин С. А. Распределение электронов в бинарных полупроводниках и явление убежания. 2, 293
- Гарбузов Д. З., Тикунов А. В., Жигулин С. Н., Соколова З. Н., Халфин В. Б. Влияние насыщения усиления на пороговые характеристики квантово-размерных InGaAsP/GaAs-гетеролазеров. 6, 1035
- Гарбузов Д. З., Чалый В. П., Свелозузов А. Е., Халфин В. Б., Тер-Мартirosян А. Л. Оже-рекомбинация и разогрев носителей при высоком уровне фотовозбуждения квантово-размерных гетероструктур InGaAsP/InP ( $\lambda=1.3$  мкм) и InGaAsP/GaAs ( $\lambda=0.85$  мкм). 4, 657
- Гарбузов Д. З., см. Алфёров Ж. И. 6, 1031
- Гарбузов Д. З., см. Алфёров Ж. И. 12, 2105
- Гарбузов Д. З., см. Алфёров Ж. И. 12, 2111
- Гасанов Н. Э., см. Гусейнов Д. Т. 5, 956
- Гасанов С. И., см. Баженов Н. Л. 2, 333
- Гаськов А. М., см. Лашкарев Г. В. 4, 766
- Гасымов Т. М., Катанов А. А. Термоэд горячих носителей тока в полупроводниках при сильной анизотропии функции распределения фононов. 1, 173
- Гасымов Т. М., Катанов А. А. Терромагнитные эффекты горячих носителей тока в полупроводниках в недиффузионном приближении для акустических фононов.\* 12, 2245
- Гасымов Т. М., Катанов А. А. Продольный эффект Нернста—Эттинггаузена электронов и фононов в полупроводниках в недиффузионном приближении.\* 12, 2246
- Гафийчук В. В., Гашпар В. Э., Кернер В. С., Осипов В. В. Пульсирующие автосолитоны в разогретой в процессе оже-рекомбинации электронно-дырочной плазме. 10, 1836.
- Гафийчук В. В., Кернер В. С., Осипов В. В., Южанин А. Г. Свойства автосолитонов в «плотной» электронно-дырочной плазме. 11, 2051
- Гафуров У. А., см. Атакулов Ш. Б. 3, 539
- Гадкевич Е. И., Малевич В. Л. Электронная проводимость расплавов кремния и германия. 4, 697
- Гашимзаде Н. Ф., см. Аскеров Б. М. 6, 1104
- Гашимзаде Ф. М., Тагиров Э. В. Поглощение света свободными носителями заряда в многодолинных полупроводниковых пленках. 7, 1328
- Гашимов Г. И., Рустамов А. Г., Мустафаев А. А. Электрические и магнитные свойства системы  $Fe_{1-x}Zn_xCr_2S_4$ . 2, 282
- Гашка К. И., см. Чеснис А. А. 6, 1132
- Гашка Р., см. Балтрамеюнас Р. 8, 1422
- Гашпар В. Э., см. Гафийчук В. В. 10, 1836
- Гельмонт Б. Л., Зебря Г. Г. Электромагнитная теория инжекционного лазера с одним гетеропереходом. 8, 1381
- Гельмонт Б. Л., Иванов-Омский В. И., Цидильковский Э. И. Индуцированная светом спиновая поляризация в полумагнитных полупроводниках. 10, 1888
- Гельмонт Б. Л., см. Барановский С. Д. 9, 1585
- Гельмонт Б. Л., см. Берковская Ю. Ф. 5, 855
- Генкин Г. М., Окомельков А. В. Инверсия населенностей при неомическом разогреве в бесщелевых полупроводниках. 6, 1085
- Генкин Г. М., Окомельков А. В., Токман И. Д. Инверсия населенностей в узкощелевых полупроводниках при фотокачке. 12, 2151
- Георгобиани А. Н., Грузинцев А. Н., Заяц А. В. Излучательная рекомбинация носителей в полупроводниках с участием бинарных комплексов дефектов. 12, 2146
- Георгобиани А. Н., Грузинцев А. Н., Заяц А. В., Левит А. Д. Влияние слабых электрических полей на фоточувствительность и люминесценцию CdS в краевой области спектра. 5, 780
- Георгобиани А. Н., Илюхин З. П., Пышная Н. Б., Тигиняну И. М., Урсаки В. В. Слои  $p$ -типа на кристаллах  $i$ -GaAs, отожженных в водород. 6, 1110
- Георгобиани А. Н., Тигиняну И. М. Антиструктурные дефекты в соединениях  $A_{III}B_{IV}$  (обзор). 1, 3
- Георгобиани А. Н., см. Веденев С. И. 5, 936
- Герасименко Н. Н., Мясников А. М., Нестеров А. А., Ободников В. И., Сафронов Л. Н., Хрящев Г. С. Конверсия типа проводимости в слоях  $p$ -InAs, облученных ионами аргона. 4, 753
- Герасименко Н. Н., см. Бобрикова О. В. 12, 2236
- Герасимов А. Б., Гоготшвили М. К., Джибути З. В., Коноваленко Б. М. О механизме перестройки комплексов в полупроводниках. 5, 920
- Герасимов А. Л., Гринсон А. А., Гуткин А. А., Прошин В. И. Влияние электрического поля на термическую эмиссию дырок собственными дефектами в  $p$ -GaAs, полученном жидкостной эпитаксией. 6, 1016
- Герман А. И., Чайковский И. А. Высококачественная проводимость неоднородных полупроводников в классическом сильном магнитном поле. 10, 1862
- Германенко А. В., Кружаев В. В., Миньков Г. М., Рут О. Э. К вопросу о гальваномагнитных эффектах в слабо легированном бесщелевом полупроводнике  $p$ - $Hg_{1-x}Cd_xTe$ . 6, 992
- Германенко А. В., Миньков Г. М., Румянцев Е. Л., Рут О. Э. Магнитное вымораживание дырок в одноосно деформированном  $p$ -InSb. 7, 1156

- Гермогенов В. П., Диамант В. М., Коротченко З. В., Криво-ротынов Н. П., Позолотин В. А. Влияние гидростатического давления на удельное сопротивление твердого раствора  $n\text{-Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{Sb}$ . 4, 623
- Гермогенов В. П., Позолотин В. А., Хлудков Л. С. Механизм прохождения тока в  $p$ - $n$ -структурах из  $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{Sb}(\text{As})$  при небольших смещениях. 5, 849
- Герчиков Л. Г., Соловьев А. В. Внутризонное поглощение света в полупроводниках при рассеянии электронов проводимости на короткодействующих потенциалах. 9, 1710
- Герчиков Л. Г., Харченко В. А. Рассеяние квазичастиц в вырожденной зоне на короткодействующих потенциалах. 5, 863
- Гершензон Е. М., см. Воеводин Е. И. 3, 540
- Гигуашвили Г. В., Сарбей О. Г. Расслоение поля в коротких образцах кремния при многозонаном распределении электронов. 6, 1053
- Гиппиус А. А., см. Пономарев В. Н. 9, 1563
- Гприй В. А., см. Акулович Н. И. 9, 1720
- Гицу Д. В., Гринчешен И. Н., Красовский В. Ф., Попович Н. С. Особенности рекомбинационных процессов в кристаллах  $n\text{-TlSbSe}$ . 1, 152
- Глазман Л. И., Каганов М. И. Осцилляции ВАХ сверхрешетки в квантовом магнитном поле. 12, 2204
- Глазман Л. И., Юрченко В. Б. Сопротивление и ВАХ чистого полупроводникового контакта в магнитном поле. 3, 465
- Глазов В. М., Ким С. Г., Сулейменов Т. Исследование поглощения звука в жидком германии. 11, 1943
- Глазов В. М., Кольцов В. Б., Курбатов В. А. Экспериментальное исследование эффекта Холла кремния вблизи температуры плавления в твердой и жидкой фазах. 2, 330
- Глазов В. М., Фараджов А. И. Исследование электронных свойств соединения  $\text{Bi}_2\text{Se}_3$  в твердом и жидком состояниях. 11, 1929
- Глазов В. М., Фараджов А. И. Исследование электронных свойств полупроводникового соединения  $\text{Sb}_2\text{Se}_3$  в области фазового перехода кристалл-расплава (включая жидкую фазу). 12, 2156
- Глобус Т. Р., см. Анисимова Н. П. 9, 1590
- Глоризова Р. И., Колесник Л. И., Колин Н. Г., Освенский В. Б. Поведение глубоких центров в ядре легированном арсениде галлия. 3, 507
- Глузман Н. Г., Леринман Н. К., Сабирзянова Л. Д., Цидильковский И. М., Горбатюк И. Н., Фрасуняк В. М. О магнитном полароне в узкощелевых кристаллах  $\text{Hg}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te}$ . 7, 1321
- Гватенко Ю. П., см. Мозоль П. Е. 9, 1595
- Говорков А. В., см. Брук А. С. 10, 1792
- Говорков А. В., см. Омеляновский Э. М. 7, 1203
- Гоготшвили М. К., см. Герасимов А. Б. 5, 920
- Голубев В. Г., Иванов-Омский В. И., Осутин А. В., Сейсян Р. П., Эфрос Ал. Л., Язева Т. В. Магнитоспектроскопия резонансных примесных состояний в полупроводниках. 8, 1416
- Голубев Л. В., Крещук А. М., Новиков С. В., Полянская Т. А., Савельев И. Г., Сайдашев И. И. Получение гетероструктур с двумерным электронным газом методом стандартной жидкофазной эпитаксии. 11, 1948
- Голубев Л. В., см. Амусья В. М. 2, 342
- Гольдберг Ю. А., Ильина М. В., Поссе Е. А., Царенков Б. В. Переход контакта полупроводник-жидкий металл от вентильного к омическому. Влияние параметров полупроводника на температуру перехода. 3, 555
- Гольдберг Ю. А., Львова Т. В., Хасиева Р. В., Царенков Б. В. Зависимость сопротивления омического контакта полупроводник-металл от ширины запретной зоны полупроводника. 9, 1712
- Гольдман Е. И., Ждан А. Г., Маркин Ю. В. Релаксационная спектроскопия границ раздела полупроводник-диэлектрик при авто- и термоавтоэмиссионном опустошении пограничных состояний. 2, 237
- Гольдман Е. И., см. Веденеев А. С. 7, 1199
- Гольцман Г. Н., см. Воеводин Е. И. 3, 540
- Горбань И. С., Корец Н. С., Крыськов Ц. А., Чукичев М. В. Излучательная рекомбинация в легированных кристаллах  $\text{CdP}_2$  и  $\text{CdSiP}_2$ . \* 9, 1718
- Горбатюк И. Н., см. Глузман Н. Г. 7, 1321
- Горбачев В. В., см. Квасков В. Б. 3, 514
- Горбачева Н. И., см. Бабицкий Ю. М. 2, 307
- Горбенко Н. В., Косяченко Л. А., Махний В. П., Шейнкман М. К. Механизм прохождения прямого тока в электролюминесцентных диодах  $\text{Au-ZnS}$ . 9, 1651
- Горбенко Н. В., Танатар М. А., Шейнкман М. К., Юрченко И. А. Спектральные характеристики светодиодов  $\text{Au-ZnS}$ . 11, 1915
- Горбовицкий Б. М. Теорема «площадей» и межзональное безстолкновительное поглощение ультракоротких импульсов света в кубическом полупроводнике. 8, 1434
- Горбовицкий Б. М. Анизотропия туннельных переходов в сложной валентной зоне германия. 10, 1894
- Гореленок А. Т., Груздов В. Г., Кумар Ракеш, Мамути В. В., Полянская Т. А., Савельев И. Г., Шмарцев Ю. В. Концентрация и подвижность электронов в  $\text{InP}$  и  $\text{In}_{0.53}\text{Ga}_{0.47}\text{As}$ , легированных редкоземельными элементами. 1, 35

- Гореленок А., см. Галванаскас А. 9, 1672
- Горин Е. А. Модель формирования  $p$ - $n$ -перехода у облученной лазером поверхности полупроводника. 2, 323
- Горлей П. Н. О температурной зависимости зонных параметров дырок в теллуре. 3, 504
- Горобей Н. Н., см. Беляков Л. В. 5, 906
- Городецкий А. Е., см. Александров П. А. 4, 731
- Городецкий М. Л., Ильченко В. С., Саава С. Э. Слабое поглощение миллиметровых волн и прыжковая проводимость в слабо легированном кремнии. 11, 2080
- Городничий О. П., см. Баранский П. И. 1, 158
- Городничий О. П., см. Беляков А. Е. 2, 335
- Горуша К. С., см. Акулович Н. И. 9, 1720
- Горфинкель В. Б., Солодка Т. И. Аналитическая теория отрицательной дифференциальной подвижности в гетероструктурах GaAs—AlGaAs. 10, 1759
- Горфинкель В. Б., Шофман С. Г. Описание переноса электронов в гетероструктурах с селективным легированием с помощью уравнений баланса. 5, 793
- Горшкова Т. А., Шадрин В. Д. Особенности энергетического спектра электронов вблизи поверхности полупроводника с отрицательным электронным средством. 2, 229
- Горячев Д. Н., см. Беляков Л. В. 5, 906
- Гостев А. В., Корнилов Б. В., Привезенцев В. В., Рау Э. И., Щетинин А. Г. Визуализация потенциального поля при возбуждении рекомбинационных волн в кремнии. 8, 1516
- Гредескул Т. С., см. Бочков В. С. 3, 396
- Греков Е. В., Сухоруков О. Г. Определение плотности локализованных состояний в  $a$ -Si: H из измерений токов, ограниченных пространственным зарядом. 4, 735
- Грессеров Б. Н., см. Выжигин Ю. В. 3, 536
- Гретчел Р., см. Базулевич Ю. Ю. 12, 2245
- Грехов А. М. Самосогласованные расчеты из первых принципов электронной структуры примесных кластеров кремния и алмаза. 8, 1439
- Грехов А. М., Дерюгина Н. И., Клапченко Г. М., Цященко Ю. П. Исследование влияния фторирования и хлорирования на электронную структуру  $a$ -Si: H. 2, 273
- Грехов А. М., Дерюгина Н. И., Цященко Ю. П. Расчет электронной структуры азотосодержащих комплексов в Si: Al.\* 5, 954
- Грехов А. М., Шаховцов В. И. Исследование электронно-колебательной структуры изоэлектронных примесей в кремнии. Изменение электронных свойств при зарождении фазы Ge в Si. 2, 285
- Грибников В. З. С., см. Борблик В. Л. 9, 1537
- Григорьев Б. И., Корольков В. И., Рожков А. В. Расчет основных характеристик фотонно-инжекционного импульсного тиристора на основе гетероструктуры. 3, 413
- Григорьев Н. Н., Зыков В. Г., Сердега Б. К., Шаховцов Л. В. Междолинный фотомагнитный эффект в кремнии. 10, 1764
- Григорьев Н. Н., см. Вирт И. С. 3, 409
- Григорян В. Г., см. Казарян А. М. 10, 1873
- Гриневич А. В., см. Вейс А. Н. 1, 171
- Гринсон А. А., см. Герасимов А. Л. 6, 1016
- Гринчешен И. Н., см. Гицу Д. В. 1, 152
- Гриштейн П. М., см. Баблицкий Ю. М. 2, 307
- Гриштейн П. М., см. Гучетль Р. И. 10, 1876
- Гришина С. П., см. Картавых А. В. 6, 1004
- Гришина С. П., см. Картавых А. В. 11, 2035
- Гродненский И. М., Пинскер Т. Н., Старостин К. В., Засвицкий И. И. Отрицательная фотопроводимость и исследование границы раздела в гетеропереходах GaAs—AlGaAs с двумерным электронным газом. 7, 1223
- Гродненский И. М., см. Галченков А. А. 7, 1196
- Гроза А. А., Литовченко Н. Г., Николаева Л. Г., Старчик М. И., Шматко Г. Г. Распад пересыщенного твердого раствора кислорода в нейтронно-облученном германии.\* 12, 2244
- Груздов В. Г., см. Акулова Ю. А. 7, 1287
- Груздов В. Г., см. Гореленок А. Т. 1, 35
- Грузинцев А. Н., см. Георгбидани А. Н. 5, 780
- Грузинцев А. Н., см. Георгбидани А. Н. 12, 2146
- Губанов В. А., см. Богданов С. В. 4, 728
- Губанова А. А., см. Арушанов Э. К. 2, 338
- Гуга К. Ю., Кислый В. П., Малютенко В. К. Влияние гидростатического давления на  $N$ -ОДП в условиях магнитоконцентрационного эффекта. 8, 1490
- Гузъ В. Н., Жадько И. П., Кучерук А. Д., Романов В. А. Ориентационная зависимость проходных вольт-амперных характеристик планарных  $p^+ - n - n^+$ -структур на основе Si. 10, 1864
- Гук Е. Г., Дьяконова Н. В., Левинштейн М. Е. Подавление светом шума  $1/f$  в кремнии. 6, 1120
- Гуламов Р. А., см. Акулова Ю. А. 7, 1287
- Гуревич Ю. Г., Машкевич О. Л., Юрченко В. Б. Вольтамперные характеристики слоев обогащения с горячими носителями тока. 11, 1955
- Гуревич Ю. Г., см. Бочков В. С. 3, 396
- Гусев А. А., см. Бутько В. Г. 6, 1139
- Гусейнов Д. Т., Мамедов З. Г., Гасанов Н. Э., Асадов Ю. Г.

- Инфракрасное, температурное и полевое гашение остаточной проводимости в монокристаллах  $\text{CdIn}_2\text{S}_4$ . 5, 956
- Гусейнов З. З., см. Мехтиев Н. М. 4, 700
- Гусейнов З. З., см. Мехтиев Н. М. 10, 1882
- Гусейнов Э. К., см. Исмаилов Н. Д. 8, 1493
- Гусинский Г. М., см. Андреев В. М. 8, 1391
- Гуткин А. А., Колчанова Н. М., Лагунова Т. С., Плотичин А. Е., Рещиков М. А., Самоуров Б. Е. Эффект Холла в  $p\text{-GaAs}\langle\text{Mn}\rangle$ . 8, 1387
- Гуткин А. А., см. Герасимов А. Л. 6, 1016
- Гуцев Г. Л., Мякенькая Г. С. Локализованные состояния водорода в аморфном кремнии. 7, 1153
- Гуцев Г. Л., Мякенькая Г. С. Электронное строение  $\langle 001 \rangle$  ориентированных кислородных и углеродных донорных комплексов в кремнии. 7, 1219
- Гучетль Р. И., Гринштейн П. М. Образование метастабильных центров в облученном кремнии. 10, 1876
- Да Кунья Лима И. К., см. Барановский С. Д. 9, 1585
- Дабаян А. В., Емцев В. В. Отжиг метастабильных пар Френкеля, образующихся в германии  $n$ -типа при низкотемпературном гамма-облучении. 4, 747
- Дабаян А. В., см. Емцев В. В. 5, 924
- Давыдов А. Б., см. Арапов Ю. Г. 5, 893
- Давыдов М. С., см. Якимчук Д. Ю. 8, 1474
- Данилин А. Б., см. Арзамасцев А. П. 11, 2063
- Даргис А. Ю., Жураускас С. В. Динамика пробоя мелких акцепторов в германии в сильных электрических полях. 3, 455
- Дахно А. Н., см. Воронина Т. И. 6, 1129
- Дахно А. Н., см. Воронина Т. И. 7, 1230
- Дашевский З. М., см. Балмуш И. И. 12, 2243
- Дашевский М. Я., Корляков Д. Н., Миляев В. А., Никитин В. А. Электрические свойства легированных германием монокристаллов кремния, подвергнутых термообработке. 6, 1146
- Двуреченский А. В., Каранович А. А. Междоузельный дефект низкой симметрии в кремнии, облученном нейтронами. 6, 1057
- Двуреченский А. В., см. Антоненко А. X. 5, 887
- Де Андрада е Силва Е. А., см. Барановский С. Д. 9, 1585
- Дедулевич С., Канцлерис Ж., Мартунас А. Особенности электропроводности  $p\text{-Ge}$  в перпендикулярном слабом электрическом поле. 4, 744
- Дедулевич С., Канцлерис Ж., Матулис А. Влияние междырочных столкновений на разогрев и поглощение света теплыми дырками в  $p\text{-Ge}$ . 5, 881
- Демаков К. Д., см. Александров П. А. 4, 731
- Демин В. Н., см. Лашкарев Г. В. 4, 766
- Демидов С. В., Косичкин Ю. В., Ларчев В. И., Ляпин А. Г., Попова С. В., Скроцкая Г. Г., Случанко Н. Е. Структурная релаксация и кристаллизация объемных образцов аморфного антимионда галлия. 9, 1666
- Денисов А. А., см. Кадушкин В. И. 3, 558
- Денисов А. Г., см. Алфёров Ж. И. 12, 2105
- Деркач Б. Е., см. Савчук А. И. 3, 512
- Дерюгина Н. И., см. Грехов А. М. 2, 273
- Дерюгина Н. И., см. Грехов А. М. 5, 954
- Джаксимов Е. К. Теории фотостимулированных гальваномагнитных эффектов в полупроводниках. 9, 1713
- Джафаров Т. Д., см. Байрамов А. И. 9, 1716
- Джибути З. В., см. Герасимов А. Б. 5, 920
- Джумамухамбетов Н. Г., Дмитриев А. Г. Фотолюминесценция модифицированных кристаллов GaAs  $\langle\text{Te}\rangle$ . 10, 1880
- Диамант В. М., см. Алексеева З. М. 10, 1743
- Диамант В. М., см. Гермогенов В. П. 4, 623
- Диджюлис А. А., Шатковский Е. В. Разогрев электронно-дырочной плазмы при стримерном разряде в полупроводниках. 8, 1412
- Дмитренко Н. Н., Огненский А. И. Исследование влияния изохронного отжига на тип проводимости и концентрацию свободных носителей заряда в НТЛ кристаллах кремния. 10, 1769
- Дмитриев А. Г., см. Джумамухамбетов Н. Г. 10, 1880
- Дмитриев А. П., Емельянов С. А., Терентьев Я. В., Ярошецкий И. Д. О возможности реализации инверсной населенности спиновых подуровней Ландау в  $n\text{-InSb}$  при интенсивном субмиллиметровом возбуждении. 6, 1045
- Дмитриев В. А., см. Вишневская Б. И. 4, 664
- Дмитриева О. Г., см. Артамонов О. М. 4, 638
- Добровинский Ю. М., Соснин М. Г., Цмоць В. М., Шаховцов В. И., Шиндич В. Л. Влияние примеси олова на накопление радиационных дефектов в  $n\text{-Si}$ . 6, 1149
- Добровольский Ю. М., см. Абдурахманов К. П. 3, 510
- Добровольский З., см. Галванасускас А. 9, 1692
- Довбыш Л. Е., Попков В. И., Романов О. Г., Цмоць В. М., Шубак М. И. Влияние реакторного облучения на электрические и магнитные свойства примесного германия. 2, 359
- Додин Е. П., см. Алешкин В. Я. 11, 1910
- Додин Е. П., см. Гавриленко В. И. 7, 1233
- Долгинов Л. М. Рецензия на книгу Лозовского В. Н., Лунина Л. С., По-

- пова В. П. Зонная перекристаллизация градиентом температуры полупроводниковых материалов. 7, 1334
- Долгих Н. И., см. Быковский В. А. 5, 960
- Доропей В. Н., см. Брандт Н. Б. 8, 1462
- Доропей В. Н., см. Брандт Н. Б. 8, 1469
- Доросинец В. А., Поклонский Н. А., Самуйлов В. А., Стельмах В. Ф. Инфранизкочастотные автоколебания тока в поликристаллическом кремнии. 4, 761
- Дошанов К. М. Адмиттанс полупроводникового бикристалла.\* 3, 566
- Дошанов К. М., Соколов В. Д. Низкочастотный импеданс диода Шоттки на основе аморфного гидрогенизированного кремния.\* 3, 564
- Дравин В. А., см. Пономарев В. Н. 9, 1563
- Дубков В. П., см. Брандт Н. Б. 8, 1462
- Дубков В. П., см. Брандт Н. Б. 8, 1469
- Дубков В. П., см. Скипетров Е. П. 10, 1785
- Дугаев В. К., Петров П. П. Энергетический спектр носителей в узкой квантовой яме в бесщелевом полупроводнике. 3, 519
- Дьяконова Н. В., Левинштейн М. Е., Румянцев С. Л. Перестройка светом шума  $1/f$  в арсениде галлия. 6, 1049
- Дьяконова Н. В., см. Гук Е. Г. 6, 1120
- Дыкман И. М., Томчук П. М. Электромагнитные волны в сверхрешетке многодолинного полупроводника, образованной когерентными волнами. 4, 768
- Дякин В. В., см. Карягин В. В. 5, 957
- Дякин В. В., см. Карягин В. В. 8, 1503
- Евтихийев В. П., см. Алфёров Ж. И. 12, 2105
- Елькин Н. В., Звягин И. П., Коробов О. Е., Курова И. А., Лупачева А. Н. Влияние освещения на проводимость легированных пленок  $\alpha$ -Si : Н. 5, 943
- Емельяненко О. В., см. Воронина Т. И. 6, 1129
- Емельяненко О. В., см. Воронина Т. И. 7, 1230
- Емельянов С. А., см. Дмитриев А. П. 6, 1045
- Емлин Р. В., Зверев Л. П., Рут О. Э. Исследование зонных параметров твердых растворов  $Al_xCa_{1-x}As$  по спектрам поглощения в квантующих магнитных полях. 2, 269
- Емцев В. В., Дабагян А. В., Витовский Н. А., Машовец Т. В. Основные характеристики пары Френкеля в германии. 5, 924
- Емцев В. В., см. Абдусаттаров А. Г. 3, 502
- Емцев В. В., см. Быковский В. А. 5, 960
- Емцев В. В., см. Витовский Н. А. 8, 1483
- Емцев В. В., см. Дабагян А. В. 4, 747
- Еремец М. И., см. Стружнин В. В. 8, 1488
- Еремин В. К., Медведев Л. С.,
- Строкан Н. Б. Принцип встроеного электрического поля в проблеме полупроводниковой спектроскопии сильно ионизирующих частиц. 7, 1239
- Еремин В. К., см. Андреев В. М. 6, 1096
- Еремин В. К., см. Андреев В. М. 8, 1526
- Еремин В. К., см. Андреев В. М. 9, 1629
- Еремин В. К., см. Андреев В. М. 11, 2039
- Ермаков М. Г., см. Поляков В. И. 8, 1446
- Ермакова О. Н., см. Поляков В. И. 8, 1446
- Ерошкин А. В., Лактюшкин В. Н. Исследование неидеальных гетеропереходов кремний—арсенид галлия методом релаксационной спектроскопии глубоких уровней. 9, 1604
- Ершов А. В., см. Павлов Д. А. 12, 2187
- Ершов А. В., см. Хохлов А. Ф. 8, 1511
- Ефанов В. М., Кардо-Сысоев А. Ф., Попова М. В. Нестационарные токи двойной инжекции в условиях насыщения скоростей дрейфа электронов и дырок. 10, 1747
- Ефанов А. В., Энтин М. В. Поведение ЭДС Дембера на горячих электродах в слабом магнитном поле. 3, 386
- Жадько И. П., Кучерук А. Д., Романов В. А., Сердега Б. К. Влияние индуцированной электрическим полем анизотропии электропроводности на вольтамперные характеристики фотопроводимости в  $n$ -Si при 77 К. 7, 1185
- Жадько И. П., см. Гувь В. Н. 10, 1864
- Жарекешев И. Х. Анизотропия прыжкового магнитосопротивления  $n$ -Ge. 9, 1623
- Ждан А. Г., Мельников А. П., Рыльков В. В. Межпримесная рекомбинация дырок через  $A^+$ -состояния в слабокомпенсированном  $p$ -Si. 6, 1011
- Ждан А. Г., см. Антоненко В. И. 2, 223
- Ждан А. Г., см. Антоненко В. И. 4, 758
- Ждан А. Г., см. Байрамов М. А. 8, 1365
- Ждан А. Г., см. Веденеев А. С. 4, 586
- Ждан А. Г., см. Веденеев А. С. 7, 1199
- Ждан А. Г., см. Гольдман Е. И. 2, 237
- Жданеев В. В., Зарифьянц Ю. А., Кашкаров П. К. Модификация оптических свойств InAs под действием импульсного лазерного облучения. 12, 2228
- Жигулин С. Н., см. Алфёров Ж. И. 12, 2111
- Жигулин С. Н., см. Гарбузов Д. З. 6, 1035
- Жигулин С. Н., см. Савченко А. П. 3, 550
- Жиляев Ю. В., Россин В. В., Россина Т. В., Травников В. В. Использование спектров поляризованной люминесценции для характеристики качества кристаллов GaAs. 10, 1885
- Жиляев Ю. В., см. Вайнштейн С. Н. 6, 1134
- Житинская М. К., Кайданов В. И., Немов С. А., Афанасьева Л. А. Особенности явления самокомпенсации в  $RbTe$   $\langle Tl, Rb_{no} \rangle$ . 11, 2043
- Жук Б. В., Зленко А. А., Прохоров А. М., Разов Е. Н., Щербачков Е. А. Быстродействующий фо-

- гетерантисигор на гетероструктуре ZnSe—GaAs. 8, 1353
- Жук Б. В., Зленко А. А., Прохоров А. М., Разов Е. Н., Щербатов Е. А. Свойства гетероструктурного фототранзистора с тонкой базой. 10, 1780
- Журавлев А. Б., Марущак В. А., Портной Е. Л., Стельмах Н. М., Титков А. Н. Время жизни неравновесных носителей заряда в  $r$ -GaAs, облученном ионами кислорода. 2, 352
- Журавлев А. Б., Плявенок А. Г., Портной Е. Л., Серегин В. Ф., Стельмах Н. М., Якубович С. Д. Динамика излучения гетеролазера с насыщающимся поглотителем, полученным глубокой имплантацией ионов кислорода. 7, 1208
- Журавлев К. С., Терехов А. С., Якушева Н. А. Фотолюминесценция комплексов в эпитаксиальном  $r$ -GaAs, сильно легированном германием. 5, 777
- Журавлев К. С., см. Якушева Н. А. 11, 2083
- Жураускас С. В., см. Даргис А. Ю. 3, 455
- Журкин Б. Г., см. Атакулов Б. А. 3, 530
- Забродин Б. В., см. Афонин О. Ф. 1, 56
- Забродский А. Г., см. Алексеенко М. В. 1, 140
- Зайцева Л. А., см. Шаронова Л. В. 1, 93
- Закиров Г. Г., Ивлев Г. Д., Хайбуллин Н. Б. Динамика наносекундного лазерного отжига аморфных и ультрадисперсных имплантационных слоев германия. 5, 947
- Закриллаев Н. Ф., см. Бахадыханов М. К. 9, 1716
- Закс М. Б., см. Абдурахманов К. П. 11, 2088
- Зарифьянц Ю. А., Карягин С. Н., Коробов О. Е., Лупачева А. Н. Фотоиндуцированные метастабильные состояния в  $a$ -Si<sub>x</sub>C<sub>1-x</sub>:H. 4, 738
- Зарифьянц Ю. А., см. Жданев В. В. 12, 2228
- Зарицкий И. М., Семенов Ю. Г. О причине аномалий спин-решеточной релаксации и низкотемпературной теплоемкости в аморфном кремнии и германии. 3, 402
- Зарубин Л. И., см. Беда А. Г. 11, 2065
- Засавицкий И. И., Ковальчик Л., Мацинашвили Б. Н., Сазонов А. В. Фотолюминесценция полупроводников типа Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>VI. 12, 2118
- Засавицкий И. И., см. Гродненский И. М. 7, 1223
- Захаров Ю. В., Материкин Д. И., Прибылов Н. Н., Бордюжа Л. П., Рембеза С. И. Эффекты электрон-фононного взаимодействия в примесной фотопроводимости  $n$ -GaP <Ni>. 3, 485
- Захарова И. Б., см. Бакуева Л. Г. 10, 1896
- Заяц А. В., см. Георгобидани А. Н. 5, 780
- Заяц А. В., см. Георгобидани А. Н. 12, 2146
- Зверев В. Н., см. Гантмахер В. Ф. 4, 575
- Зверев Л. П., см. Емлин Р. В. 2, 269
- Зверев М. М., см. Арсеньев В. Г. 8, 1401
- Зверева М. Л., см. Арапов Ю. Г. 5, 893
- Звоная Т. К., см. Аверьянов В. Л. 11, 2093
- Звягин И. П., см. Елькин Н. В. 5, 943
- Зегря Г. Г., см. Гельмонт Б. Л. 8, 1381
- Земсков Б. Г., Любимов В. С., Мартынюк А. Н., Артемова А. А., Пермьяков Ю. В., Ионов С. П. К вопросу о двухэлектронном обмене в легированных твердых растворах Pb(Sn)Se. 5, 934
- Зимин С. П., см. Бочкарева Л. В. 4, 675
- Зленко А. А., см. Жук Б. В. 8, 1353
- Зленко А. А., см. Жук Б. В. 10, 1780
- Злобин В. П., см. Капустин Ю. А. 9, 1708
- Золотарев С. В., Корбутяк Д. В., Кучма Н. И., Литовченко В. Г., Никонок Е. С. Люминесцентные и электрофизические свойства кристаллов CdTe <Se>. 6, 1062
- Зудеев О. Г., Иванченко В. А., Науменко Г. Ю., Николаев М. В. Разогрев носителей заряда в германии ИК излучением. 5, 938
- Зыков В. Г., см. Григорьев Н. Н. 10, 1764
- Зыков Н. В. Прыжковый перенос фото-возбужденных носителей в тонких пленках неупорядоченных полупроводников. 11, 2095
- Зюзин А. Ф., Спивак Б. З., Соколов В. Н., Фишков А. В. Теория мезоскопических флуктуаций сопротивления проводников со сложной геометрии. 2, 341
- Иванов С. В., см. Ивченко Е. А. 5, 784
- Иванов М. Г., Меркулов И. А., Эфрос Ал. Л. Энергия и ширина примесного уровня вблизи гетерограницы. 4, 628
- Иванов-Омский В. И., см. Баженов Н. Л. 2, 333
- Иванов-Омский В. И., см. Баженов Н. Л. 7, 1258
- Иванов-Омский В. И., см. Гельмонт Б. Л. 10, 1888
- Иванов-Омский В. И., см. Голубев В. Г. 8, 1416
- Иванченко В. А., см. Зудеев О. Г. 5, 938
- Ивлев Г. Д., см. Баязитов Р. М. 1, 79
- Ивлев Г. Д., см. Закиров Г. Г. 5, 947
- Ивченко Е. Л., Копьев П. С., Кочерешко В. П., Уральцев И. Н., Яковлев Д. Р., Иванов С. В., Мельцер Б. Я., Калитивеский М. А. Отражение в экситонной области спектра структуры с одиночной квантовой ямой. Наклонное и нормальное падение света. 5, 784
- Ивченко Е. Л., Кособукин В. А. Экситонные поляритоны в полупроводниках со сверхрешеткой. 1, 24
- Игнатьева Е. А., см. Хохлов А. Ф. 8, 1511
- Илнев Х. М., см. Бахадыханов М. К. 1, 123
- Ильин В. И., см. Бакуева Л. Г. 8, 1495

- Ильин В. И., см. Бакуева Л. Г. 10, 1896  
Ильин М. А., см. Бабичкий Ю. М. 2, 307  
Ильин Н. П., см. Васильев А. Э. 7, 1253  
Ильина М. В., см. Гольдберг Ю. А. 3, 555  
Ильченко В. В., см. Стриха В. И. 3, 461  
Ильченко В. С., см. Городецкий М. Л. 11, 2080  
Илюхина Э. П., см. Георгоблани А. Н. 6, 1110  
Ионикас Л. Ю., см. Квасов Н. Т. 5, 806  
Ионов С. П., см. Земсков Б. Г. 5, 934  
Иоффе И. В. О возможности полупроводникового аналога эффекта Марантони. 2, 347  
Исмаилов Ж. Т., Кульбачинский В. А., Чудинов С. М., Гавалешко Н. П., Марьянчук П. Д. Перетекание электронов на примесный уровень в  $Hg_{1-x}Mn_xSe$  под давлением. 3, 375  
Исмаилов Н. Д., Гусейнов Э. К., Курбанов Э. И. Влияние промежуточного диэлектрического слоя на фототок в поверхностно-барьерных структурах металл- $n-Cd_xHg_{1-x}Te$ . 8, 1493  
Итальянцев А. Г., Курбаков А. И., Мордкович В. Н., Рубинова Э. Э., Темпер Э. М., Трунов В. А. Влияние нейтронного облучения и отжига на свойства кремния, легированного германием. 5, 834  
Кабанова И. С., Косяченко Л. А., Махний В. П. Нахождение закона дисперсии в запрещенной зоне полупроводника из измерений туннельного обратного тока в диоде Шоттки. 10, 1852  
Кабачкий В. Н., см. Малютенко В. К. 4, 593  
Кабулов Р., см. Аронов Д. А. 9, 1719  
Кабыченков А. Ф. Немонотонность проводимости инверсионных  $p$ -каналов. 3, 369  
Кавалаяускас А. А., Пека Г. П., Приступа П. В., Смоляр А. Н., Черюканов С. Д., Шилленас А. Л., Шимулите Е. А. Влияние магнитного поля на вольтамперные характеристики плавных  $p^+-n$ -гетероструктур из  $Al_xGa_{1-x}As$ . 12, 2177  
Кавалаяускас А. А., см. Пека Г. П. 4, 618  
Кагадей В. А., см. Базулевич Ю. Ю. 12, 2245  
Каганов М. И., см. Глазман Л. И. 12, 2204  
Кадушкин В. И., Денисов А. А. Фотомагнитный эффект в  $n-InSb$  в квантовом пределе. 3, 558  
Казакевич Л. А., Кузнецов В. И., Лугаков П. Ф. Формирование областей скопления радиационных дефектов в дислокационном кремнии. 3, 499  
Казакова В. М., см. Бобровников Ю. А. 2, 301  
Казакова Л. П., см. Архипов В. И. 4, 723  
Казанский А. Г., см. Болд З. 12, 2173  
Казанский А. Г., см. Буторин О. В. 1, 84  
Казарян А. М., Григорян В. Г. Внутризонное поглощение в размерно-квантованных полупроводниковых средах. 10, 1873  
Казлаускас А., см. Балтрамеюнас Р. 7, 1163  
Казьмин С. А., см. Атакулов Ш. Б. 3, 539  
Кайданов В. И., см. Вейс А. Н. 1, 171  
Кайданов В. И., см. Вейс А. Н. 2, 349  
Кайданов В. И., см. Житинская М. К. 11, 2043  
Калинин Ю. М., Криворотов Н. П. Влияние температуры и гидростатического давления на междузонный ток туннельных дпадов  $GaAs$ . 2, 219  
Калиновский В. С., см. Андреев В. М. 8, 1391  
Калинушкин В. П., Мурзина Т. М., Тиггияну И. М., Юрьев В. А. Влияние отжига на рассеяние света примесными скоплениями в полупроводящих кристаллах  $InP: Fe$  и  $GaAs: Cr$ . 6, 1112  
Калинушкин В. П., см. Батулина А. В. 7, 1308  
Калитенко В. А., Кучеров И. А., Перга В. М. Акустоэмиссия полупроводников при протекании электрического тока. 4, 578  
Калитиевский М. А., см. Ивченко Е. Л. 5, 784  
Кальфа А. А., Пашковский А. Б. Двумерный электронный газ в пространственно неоднородной потенциальной яме. 11, 2090  
Камилов Т. С., см. Алибаев А. С. 3, 566  
Канцлерис Ж., см. Дедулевич С. 4, 744  
Канцлерис Ж., см. Дедулевич С. 5, 881  
Капустин Ю. А., Колокольников Б. М., Свешников А. А., Злобин В. П. Электрические свойства дефектов, образующихся при импульсном фотонном отжиге кремния. 9, 1708  
Каранович А. А., см. Двуреченский А. В. 6, 1057  
Карачевцева М. В., Страхов В. А., Яременко Н. Г. Фотоэлектрические свойства неидеальных гетероструктур  $InGaAsP/InP$ . 11, 1936  
Кардашев Д. Л., см. Баженов В. К. 1, 179  
Кардо-Сысоев А. Ф., см. Ефанов В. М. 10, 1747  
Карлик И. Я., см. Алексеев М. А. 4, 569  
Карпов А. В., см. Болотов В. В. 1, 49  
Карпова И. В., Саблюков В. А., Сыровегин С. М. Режимы генерации рекомбинационных волн конечной амплитуды. 4, 609  
Карпус В. Энергетическая релаксация двумерных электронов при пьезоакустическом рассеянии. 3, 439  
Карпус В., см. Абакумов В. Н. 2, 262  
Карпухин В. В., см. Якимчук Д. Ю. 8, 1474  
Картавых А. В., Гришина С. П., Мильвидский М. Г., Рытова Н. С., Степанцова И. В., Юр-

- ва Е. С. Механизм формирования неоднородности в нелегированных монокристаллах арсенида галлия, полученных методом Чохральского. 6, 1004
- Картавых А. В., Марков А. В. О связи концентрации глубоких центров  $EL2$  и плотности дислокаций в полупроводнике GaAs. 9, 1702
- Картавых А. В., Юрова Е. С., Мильвидский М. Г., Гришина С. П., Ковальчук И. А. Поведение центров  $EL2$  в монокристаллах полупроводникового GaAs при термообработках. 11, 2035
- Карумидзе Г. С., Трахброт Б. М. Спектры поглощения кремния, облученного реакторными нейтронами при криогенных температурах. 10, 1848
- Карягин В. В., Ляпилин И. И., Дякин В. В. Термозлектрические коэффициенты инверсного слоя гетероструктуры  $GaAs-Al_xGa_{1-x}As$  в условиях квантового эффекта Холла (КЭХ). \* 5, 957
- Карягин В. В., Ляпилин И. И., Дякин В. В. Термозде увлечения  $2D$ -электронного газа гетероструктуры  $GaAs-GaAlAs$ . 8, 1503
- Карягин С. Н., см. Зарифьянц Ю. А. 4, 738
- Каряев В. Н., см. Бильгильдеева Т. Ю. 3, 381
- Каряев В. Н., см. Шаронова Л. В. 1, 93
- Касаткин В. В., см. Абдурахманов К. П. 11, 2088
- Касиян А. И., Сур И. В. ИК поглощение свободными носителями при их рассеянии на примесях и плазмон-фононных колебаниях. 6, 1127
- Касиян А. И., см. Балмуш И. И. 12, 2243
- Катанов А. А., см. Гасымов Т. М. 1, 173
- Катанов А. А., см. Гасымов Т. М. 12, 2245
- Катанов А. А., см. Гасымов Т. М. 12, 2246
- Катков Б. М., Савостьянов А. В., Цанев В. С. О возможностях оптимизации алгоритмов решения задач спектроскопии пограничных состояний с применением метода регуляризации Тихонова. \* 5, 959
- Качабеков М. М., Юнович А. Э. Влияние примесей водорода и азота на люминесценцию эпитаксиальных пленок теллурида свинца. 5, 815
- Качлишвили З. С., Хизанишвили Э. Г. Зависимость пробивного поля ( $E_{пр}$ ) от степени компенсации (С) в  $n-Ge$ . 8, 1507
- Кашкаров П. К., см. Жданев В. В. 12, 2228
- Квасков В. Б., Горбачев В. В. Об эффективности фотоэмиссии с поверхности (111) алмаза с отрицательным электронным средством. 3, 514
- Квасков Н. Т., Ионикас Л. Ю., Ярашюнас К. Ю. Исследование кинетики упорядочения дефектно-примесной системы кремния. 5, 806
- Квон З. Д., см. Быков А. А. 9, 1706
- Кернер Б. С., см. Гафийчук В. В. 10, 1836
- Кернер Б. С., см. Гафийчук В. В. 11, 2051
- Кершулис С., см. Галванускас А. 9, 1672
- Кикоин К. А., см. Ванем Р. А. 2, 255
- Ким С. Г., см. Глазов В. М. 11, 1943
- Кирсон Я. Э., Клотыньш Э. Э., Крумина Я. К. Компенсация доноров в фосфиде индия медью. \* 3, 565
- Кирсон Я. Э., см. Валдатс Г. А. 9, 1717
- Кирюшкин Е. М., см. Войцеховский А. В. 12, 2226
- Киселев В. А., см. Берковиц В. Л. 1, 66
- Кисин М. В., Петросян В. И. Квантовый размерный эффект в узкощелевых полупроводниках. 5, 829
- Кислый В. П., см. Гуга К. Ю. 8, 1490
- Кистович Ю. В. Дисперсия косых медленных поверхностных магнитоплазменных волн. 9, 1678
- Клапченко Г. М., см. Грехов А. М. 2, 273
- Климашин И. В., см. Болд З. 12, 2173
- Климов А. Э., см. Васин О. И. 7, 1299
- Климов Г. Н., см. Болотов В. В. 2, 210
- Климонский С. О., см. Андрианов Д. Г. 4, 670
- Клотыньш Э. Э., см. Валдатс Г. А. 9, 1717
- Клотыньш Э. Э., см. Кирсон Я. Э. 3, 565
- Клюй Н. И., см. Гавриленко В. И. 7, 1302
- Князев А. Ф., см. Арушанов Э. К. 2, 338
- Ковалев А. Н., Остробородова В. В., Фоломин П. И. Глубокие уровни в запрещенной зоне нелегированного PbTe. 9, 1601
- Коваленко И. Д., см. Вишневская Б. И. 4, 664
- Коваль А. В., Симашкевич А. В., Сушкевич К. Д., Хельмау А. Фотолюминесценция твердых растворов  $ZnSe_{1-x}Te_x$ . 5, 932
- Ковальчик Л., см. ЗасаVICкий И. И. 12, 2118
- Ковальчук В. Б., см. Бабиц В. М. 5, 956
- Ковальчук И. А., см. Картавых А. В. 11, 2035
- Ковальчук И. А., см. Марков А. В. 1, 44
- Ковалюк З. Д., см. Брандт Н. Б. 9, 1657
- Ковалюк З. Д., см. Мозоль П. Е. 9, 1595
- Ковешников С. В., Носенко С. В., Якимов Е. Б. Перестройка радиационных дефектов в Si, стимулированная атомарным водородом. 5, 922
- Коган Л. М., см. Вишневская Б. И. 4, 664
- Коган Ш. М., см. Веденев А. С. 4, 586
- Кодалашвили М. З., см. Бакши И. С. 12, 2182
- Козлов В. А., см. Алешкин В. Я. 11, 1910
- Козловский В. В., см. Афонин О. Ф. 1, 56
- Козуб В. И. Новые книги по полупроводникам. ВВ. 2, 3, 4, 7, 10
- Козырев С. В., Маслов А. Ю. Влияние флуктуаций состава твердых растворов на подвижность двумерного электронного газа в полупроводниковых гетероструктурах. 3, 433
- Козырев С. В., Шик А. Я. Захват и рекомбинация неравновесных носите-



- лей в структурах с квантовыми ямами. 1, 105
- К о к а А. П., см. Абдулгафаров С. Е. 7, 1171
- К о л д а е в И. М. Аккумуляция в  $n^+ - n - n^+$ -структурах на основе  $A^{III}V^{IV}$  при различных длинах волн фотовозбуждения. 8, 1505
- К о л е с н и к Т. И., см. Глоризова Р. И. 3, 507
- К о л е с н и к о в Н. В., Ломасов В. Н., Мальханов С. Е. Спектр и пространственное распределение радиационных дефектов в облученном протоном кремнии. 3, 534
- К о л и н А. Г., см. Коршунов Ф. П. 10, 1850
- К о л и н Н. Г., Куликова Л. В., Освенский В. Б. Легирование арсенида галлия облучением нейтронами при высоких температурах. 6, 1025
- К о л и н Н. Г., см. Глоризова Р. И. 3, 507
- К о л о д и н Л. Г., Мукашев Б. Н., Смирнов В. В., Чихрай Е. В. Диффузия радиационных дефектов из области упругого термоотражения ионов фосфора в кремнии. 5, 821
- К о л о к о л ь н и к о в Б. М., см. Капустин Ю. А. 9, 1708
- К о л о м з а р о в Ю. В., см. Попов В. Г. 10, 1867
- К о л ч а н о в а Н. М., см. Гуткин А. А. 8, 1387
- К о л ь ц о в В. Б., см. Глазов В. М. 2, 330
- К о л ь ч е н к о Т. И., Ломако В. М., Мороз С. Е. О дефектах, возникающих в  $n$ -InP при низкотемпературном облучении. 4, 740
- К о л ь ч е н к о Т. И., Ломако В. М., Мороз С. Е. Влияние легирования серой на образование глубоких центров в  $n$ -InP при облучении. 7, 1311
- К о л ы ш к и н В. И., см. Алфёров Ж. И. 6, 1031
- К о м а р е н к о Р. П., см. Попов В. Г. 10, 1867
- К о м и с с а р о в А. Б., см. Алфёров Ж. И. 12, 2105
- К о м и с с а р о в Г. П., см. Баранюк В. Б. 4, 733
- К о м и с с а р о в Г. П., см. Манассон В. А. 7, 1322
- К о н а к о в а Р. В., Мельникова Ю. С., Моздор Е. В., Файнберг В. И. Пробой кремниевых  $p^+ - n - n^+$ -диодов. 10, 1754
- К о н д р а т ь е в а О. Г., Неустроев Л. Н., Осипов В. В. Поперечная фотопроводимость легированной сверхрешетки. 12, 2131
- К о н и н А. М., Рудайтис В. Г., Сацук А. П. Исследование термоградиентного эффекта магнитоконцентрационного эффекта в неоднородном магнитном поле. 7, 1283.
- К о н н и к о в С. Г., Уманский В. Е., Чистяков В. М., Лодыженский И. И. Определение времени жизни неосновных носителей в полупроводниках при возбуждении электронным пучком в РЭМ. 10, 1803
- К о н о в а л е н к о Б. М., см. Герасимов А. Б. 5, 920
- К о н о н ч у к О. В., см. Брайтенштайн О. 9, 1687
- К о н с т а н т и н о в А. О. О механизме диффузии бора в карбиде кремния. 1, 164
- К о н с т а н т и н о в О. В. Рецензия на книгу Аскерова Б. М. Электронные явления переноса в полупроводниках. 7, 1334
- К о н с т а н т и н о в О. В., Мезрин О. А. Теория баллистического переноса горячих носителей в биполярном гетеротранзисторе с тонкой базой. 11, 2025
- К о н с т а н т и н о в О. В., Мезрин О. А., Царенков Б. В. Аномальный дрейф горячих фотоносителей в контактном поле. 1, 129
- К о н с т а н т и н о в а Н. Н., Прочухан В. Д., Рудь Ю. В., Таиров М. А. Спектры фоточувствительности контакта I—III—V<sub>2</sub>—электродит. 9, 1699
- К о н с т а н т и н о в а Н. Н., Рудь Ю. В., Таиров М. А. Фазовый переход халькопирит  $\rightleftharpoons$  сфалерит в полупроводниках II—IV—V<sub>2</sub>. 9, 1580
- К о н ч и ц А. А., см. Бабич В. М. 5, 956
- К о п ь е в П. С., Кочерешко В. П., Уральцев И. Н., Яковлев Д. Р. Определение профиля концентрации мелких примесей методом поляризованной люминесценции в структурах с квантовыми ямами. 4, 597
- К о п ь е в П. С., Леденцов Н. Н. Молекулярно-пучковая эпитаксия гетероструктур на основе соединений  $A^{III}B^{IV}$  (обзор). 10, 1729
- К о п ь е в П. С., Уральцев И. Н., Эфрос Ал. Л., Яковлев Д. Р., Винокурова А. В. Локализация квазидвумерных экситонов на островковых увеличениях ширины квантовой ямы. 3, 424
- К о п ь е в П. С., см. Ивченко Е. Л. 5, 784
- К о п ы т С. П., см. Арсеньев В. Г. 8, 1401
- К о р б у т ь к Д. В., см. Золотарев С. В. 6, 1062
- К о р е ц Н. С., см. Горбань И. С. 9, 1718
- К о р ж у е в М. А. О зонной модели GeTe. 7, 1318
- К о р л я к о в Д. Н., см. Дашевский М. Я. 6, 1146
- К о р н е е в а Л. А., Мазур Е. А., Руденко А. И. Формирование профиля ионов, имплантируемых ориентруемым пучком в полупроводник с дефектами. 10, 1859
- К о р н и л о в Б. В. Расширение температурной области существования рекомбинационных волн в полупроводниках методом оптической инжекции.\* 9, 1715
- К о р н и л о в Б. В., см. Гостев А. В. 8, 1516
- К о р о б о в О. Е., см. Елькин Н. В. 5, 943
- К о р о б о в О. Е., см. Зарифьянц Ю. А. 4, 738
- К о р о л е в В. Л., Россин В. В., Сидоров В. Г. Внешний квантовый выход светодиодов из GaAs<Si>. 3, 532
- К о р о л е в В. Л., Сидоров В. Г. Механизмы излучательной рекомбинации в сильно легированном компенсированном арсениде галлия. 8, 1359
- К о р о л е в В. Л., Сидоров В. Г. Сравнительное исследование люминес-

- ценции GaAs(Si) при фото- и электровозбуждении. 10, 1827
- Король В. М. О возможности обнаружения остаточных дефектов в ионно-легированных слоях кремния с помощью наблюдения диффузии имплантированных атомов натрия. 11, 2086
- Корольков В. И., см. Акулова Ю. А. 7, 1287
- Корольков В. И., см. Григорьев Б. И. 3, 413
- Коротеев Ю. М., см. Фялипенко Л. А. 7, 1313
- Коротченко З. В., см. Гермогенов В. П. 4, 623
- Коршунов Ф. П., Соболев Н. А., Колин А. Г., Кудрявцева Е. А., Прохоренко Т. А. Импульсный отжиг ядерно легированного арсенида галлия. 10, 1850
- Коршунов Ф. П., см. Акулович Н. И. 9, 1720
- Косичкин Ю. В., см. Деминшев С. В. 9, 1666
- Кособукин В. А., см. Ивченко Е. Л. 1, 24
- Костовецкий М. В., см. Галченко Л. А. 7, 1193
- Косяченко Л. А., см. Горбешко Н. В. 9, 1651
- Косяченко Л. А., см. Кабапова И. С. 10, 1852
- Котина И. М., Курятков В. В., Новиков С. Р., Прокофьева Т. И. Взаимодействие лития с многозарядными акцепторами I группы в германии. 12, 2165
- Кочелап В. А., Кулиш Н. Р., Лисца М. П., Малыш Н. И., Соколов В. Н. Динамика волнового просветления монокристаллов CdSe. 5, 868
- Кочерешко В. П., см. Ивченко Е. Л. 5, 784
- Кочерешко В. П., см. Копьев П. С. 4, 597
- Крайчинский А. Н., Мизрухин Л. В., Осташко Н. И., Шаховцов В. И. Рекомбинационные и компенсирующие дефекты в  $n$ -Si при облучении одиночными импульсами электронов большой интенсивности. 2, 215
- Красильник З. Ф. Отрицательные массы и отрицательная проводимость на циклотронном резонансе в полупроводниках  $p$ -типа группы АIIIВV. 1, 101
- Красильник З. Ф., см. Баширов Р. И. 3, 479
- Красильник З. Ф., см. Гаврилево В. И. 7, 1233
- Красильникова Л. М., см. Алексеева З. М. 10, 1743
- Красовский В. Ф., см. Гицу Д. В. 4, 152
- Крещук А. М., Лауре Е. П., Полянская Т. А., Савельев И. Г., Сайдашев И. И., Семашко Е. М. Электроинная температура в режиме квантового эффекта Холла. 12, 2162
- Крещук А. М., Мартисов М. Ю., Полянская Т. А., Савельев И. Г., Сайдашев И. И., Шик А. Я., Шмарцев Ю. В. Роль высших подзон в энергетической релаксации двумерного электронного газа. 4, 604
- Крещук А. М., см. Голубев Л. В. 11, 1948
- Криворотов Н. П., см. Алексеева З. М. 10, 1743
- Криворотов Н. П., см. Гермогенов В. П. 4, 623
- Криворотов Н. П., см. Калинин Ю. М. 2, 219
- Кристофель Н. П., Пищев А. Г. Когерентный фотовольтаический эффект в поле эллиптически поляризованной световой волны. 4, 742
- Критская Т. В., см. Кустов В. Б. 2, 313
- Кружаев В. В., см. Гермавенко А. В. 6, 992
- Круминя Р. К., см. Кирсон Я. Я. 3, 565
- Крупницкая Р. Ю., см. Вейс А. Н. 2, 349
- Крупницкая Р. Ю., см. Вейс А. Н. 8, 1514
- Крыськов Ц. А., см. Горбань И. С. 9, 1718
- Крючков С. В., Сыродоев Г. А. Ионизация примесных центров в узкозонных полупроводниках переменным электрическим полем. 9, 1695
- Кубертавичус В., см. Балтрамеюнас Р. 7, 1163
- Кудеяров Ю. А., см. Арсеньев В. Г. 8, 1401
- Кудрявцева Е. А., см. Коршунов Ф. П. 10, 1850
- Кудрявцева Р. В., см. Павлов Д. А. 12, 2187
- Кузнецов А. В. Двухлучевая оптическая бистабильность в полупроводниках. 10, 1808
- Кузнецов В. И., см. Блецкан Н. И. 12, 2223
- Кузнецов В. И., см. Казакевич Л. А. 3, 499
- Кузнецов В. П., см. Бабицкий Ю. М. 2, 307
- Кузнецов Н. В., см. Войцеховский А. В. 12, 2226
- Кузнецов О. А., см. Орлов Л. К. 11, 1994
- Кузьмин И. А., см. Алфёров Ж. И. 12, 2111
- Кулиев Б. И., см. Аскеров Б. М. 6, 1104
- Куликов Г. С., см. Абдурахмапов К. П. 11, 2088
- Куликов Г. С., см. Аблова М. С. 1, 20
- Куликова Л. В., см. Колин Н. Г. 6, 1025
- Кулиш Н. Р., см. Кочелап В. А. 5, 868
- Кульбачинский В. А., см. Брандт Н. Б. 9, 1657
- Кульбачинский В. А., см. Исмаилов Ж. Т. 3, 375
- Кульбачинский В. А., см. Матвеев Г. А. 5, 799
- Кумар Ракеш, см. Гореленок А. Т. 1, 35
- Кунгелис А. А., см. Бразис Р. С. 9, 1614
- Куюкшис Э., см. Балтрамеюнас Р. 8, 1422
- Курбаков А. И., см. Итальянцев А. Г. 5, 834
- Курбанов К. Р., Палкин А. М., Скубневский Э. В., Станкевич Е. Т. Электрические свойства

- Pb<sub>1-x</sub>Sn<sub>x</sub>Te<Br> механизмы рассеяния электронов. 8, 1509
- Курбанов К. Р., см. Войцеховский А. В. 12, 2226
- Курбанова Э. И., см. Исмаилов Н. Д. 8, 1493
- Курбатов В. А., см. Галкин М. Г. 6, 1122
- Курбатов В. А., см. Глазов В. М. 2, 330
- Курек И. Г., см. Мельничук С. В. 9, 1719
- Курмашев Ш. Д., Видулин И. М., Чалай И. И. Фотоприемник с инжекционным усилением на основе поверхностно-барьерной структуры.\* 12, 2244
- Курова И. А., см. Елькин Н. В. 5, 943
- Курятков В. В., см. Котиша И. М. 12, 2165
- Кустов В. Е., Критская Т. В., Трипачко Н. А., Шаховцов В. И. Влияние германия на внутренние упругие напряжения в кислородосодержащем кремнии. 2, 313
- Кустов В. Е., Трипачко Н. А., Чесноков С. А., Шаховцов В. И., Шпидич В. Л. Внутренние упругие напряжения в кремнии, легированном гадолинием. 12, 2220
- Кустов Е. Ф., см. Филиков В. А. 5, 958
- Кутукова О. Г., см. Александров П. А. 4, 731
- Кучеров И. Я., см. Калитенко В. А. 4, 578
- Кучерук А. Д., см. Гузь В. Н. 10, 1864
- Кучерук А. Д., см. Жадько И. П. 7, 1185
- Кучинский П. В., Ломако В. М., Рутковский И. З., Счастный В. В., Тарасевич А. Д., Шахлевич Л. Н. О влиянии германия на образование электрически активных дефектов в кремнии. 4, 634
- Кучинский П. В., Ломако В. М., Шахлевич Л. Н. О природе дефектов с уровнем  $E_c - 0.18$  эВ в кремнии. 7, 1213
- Кучма А. Е., Свердлов В. А. Особенности локализации носителей в обогащенном слое на поверхности узкощелевого полупроводника. 8, 1500
- Кучма Н. И., см. Золотарев С. В. 6, 1062
- Кушир П. Г., Малышев С. А., Рыжков М. П., Трофименко Е. Е. Фототок в варизонной структуре при нестационарном возбуждении. 4, 582
- Лавренюк М. Ю., см. Богданов Е. В. 8, 1348
- Лаврушин Б. М., Набиев Р. Ф., Попов Ю. М. Поглощение света в полупроводниковых соединениях A<sup>III</sup>B<sup>V</sup> р-типа. 4, 710
- Лагунова Т. С., см. Воронина Т. И. 1, 147
- Лагунова Т. С., см. Воронина Т. И. 6, 1129
- Лагунова Т. С., см. Воронина Т. И. 7, 1230
- Лагунова Т. С., см. Гуткин А. А. 8, 1387
- Ладыженский И. П., см. Конников С. Г. 10, 1803
- Лазебник И. М., см. Беда А. Г. 11, 2065
- Лакеев В. М., см. Андрианов Д. Г. 4, 670
- Лактюшин В. П., см. Ерошкин А. В. 9, 1604
- Ларионов В. Р., см. Алфёров Ж. И. 10, 1775
- Ларкин И. А. Рассеяние двумерных носителей тока на отдаленной кулоновской примеси. 11, 2008
- Ларчев В. И., см. Демисhev С. В. 9, 1666
- Латинис В., см. Вайнерт Х. 12, 2232
- Латушко Я. И., Петров В. В. Радиационные дефекты в Si:Al, облученном быстрыми электронами.\* 12, 2247
- Лаурс Е. П., см. Крещук А. М. 12, 2162
- Лашкарев Г. В., Бродовой А. В., Радченко М. В., Демин В. Н., Гаськов А. М. Магнитная восприимчивость и термоэдс вблизи фазового перехода в твердом растворе PbTe<sub>1-x</sub>S<sub>x</sub>. 4, 766
- Лашкул А. В., см. Арушанов Э. К. 2, 338
- Лебедев А. А., Султанов Н. А. Влияние ориентированной деформации и  $\gamma$ -облучения на уровни платины в кремнии. 1, 16
- Лебедев А. А., см. Аникин М. М. 1, 133
- Лебедев А. А., см. Аникин М. М. 2, 298
- Лебедев Э. А., см. Архипов В. И. 4, 723
- Лебедева Н. И., см. Базулевич Ю. Ю. 12, 2245
- Левин Е. И., Монахов А. М., Рогачев А. А. О возможности немонотонного хода потенциала в аккумуляторном слое. 3, 450
- Левин Е. И., Рузин И. М., Шкловский Б. И. Поперечная прыжковая проводимость аморфных пленок в сильных электрических полях. 4, 642
- Левинсон И. Б., см. Бадалин С. М. 11, 2019
- Левит А. Д., см. Веденев С. И. 5, 936
- Левит А. Д., см. Георгибидани А. Н. 5, 780
- Левинштейн М. Е., см. Аникин М. М. 9, 1574
- Левинштейн М. Е., см. Вайнштейн С. Н. 6, 1134
- Левинштейн М. Е., см. Гук Е. Г. 6, 1120
- Левинштейн М. Е., см. Дьяконова Н. В. 6, 1049
- Леденцов Н. Н., см. Копьев П. С. 10, 1729
- Леонов В. В. Прогнозирование типа проводимости эвтектических сплавов A<sup>III</sup>B<sup>V</sup>-Ge (Si). 8, 1519
- Леринман Н. К., см. Глазман Н. Г. 7, 1321
- Либерис Ю., см. Барейкис В. 6, 1040
- Лиленко Ю. В., см. Войцеховский А. В. 12, 2226
- Липник А. А. «Вестокое» планарное магнитоусиление гидро- и мезозвука в изотропных и анизотропных полупроводниках. 12, 2218
- Лисица М. П., см. Артамонов В. В. 11, 1961

- Лисица М. П., см. Кочелав В. А. 5, 868
- Лисунов К. Г., см. Арушанов Э. К. 2, 338
- Литвинский Л. Б., см. Алексеев Е. С. 11, 2059
- Литовский Р. Н. Влияние инверсионного слоя на туннельную полевую генерацию носителей тока в МДП структурах. 4, 716
- Литовский Р. Н., Лысенко В. С., Руденко Т. Е. Долговременные релаксации тока при туннельной перезарядке глубоких уровней в полупроводнике поверхностно-барьерных структур. 5, 875
- Литовченко В. Г., см. Артамонов В. В. 11, 1961
- Литовченко В. Г., см. Гавриленко В. И. 7, 1302
- Литовченко В. Г., см. Золотарев С. В. 6, 1062
- Литовченко П. Г., см. Гроза А. А. 12, 2244
- Лифшиц Т. М., см. Веденеев А. С. 4, 586
- Лихтер А. И., см. Алексеев Е. С. 11, 2059
- Логин В. М., см. Архипов В. И. 2, 276
- Ломако В. М., см. Кольченко Т. И. 4, 740
- Ломако В. М., см. Кольченко Т. И. 7, 1311
- Ломако В. М., см. Кучинский П. В. 4, 634
- Ломако В. М., см. Кучинский П. В. 7, 1213
- Ломасов В. Н., см. Колесников Н. В. 3, 534
- Лончаков А. Т., Матвеев Г. А., Цидильковский И. М. Особенности термомагнитных эффектов в *n*-Ge вблизи перехода металл—диэлектрик. 8, 1396
- Лончаков А. Т., Цидильковский И. М., Матвеев Г. А. Термоэдс *n*-Ge вблизи перехода металл—диэлектрик. 5, 839
- Лончаков А. Т., см. Матвеев Г. А. 5, 799
- Лугаков П. Ф., Лукашевич Т. А. Эффективность образования фосфоросодержащих комплексов при электронном  $\gamma$ -облучении кремния. 11, 2071
- Лугаков П. Ф., см. Блецкан Н. И. 12, 2223
- Лугаков П. Ф., см. Казакевич Л. А. 3, 499
- Лушковский А. В., см. Андроник К. И. 10, 1878
- Лукашевич Т. А., см. Лугаков П. Ф. 11, 2071
- Лукомский А. И., см. Аксенов И. А. 5, 961
- Лумер А. В., см. Вейс А. Н. 8, 1514
- Лунов А. В., Рудь Ю. В., Таиров М. А., Ундалов Ю. К. Поляризационная фоточувствительность анизотипных структур *n*-SnO<sub>2</sub>—*p*-CdGeP<sub>2</sub>(Ga). 6, 1115
- Луначева А. Н., см. Елькин Н. В. 5, 943
- Луначева А. Н., см. Зарифьянц Ю. А. 4, 738
- Львова Т. В., см. Гольдберг Ю. А. 9, 1712
- Лысенко В. С., см. Литовский Р. Н. 5, 875
- Лыук П. А., см. Ванем Р. А. 2, 255
- Любимов В. С., см. Земсков Б. Г. 5, 934
- Любин В. М., см. Аверьянов В. Л. 11, 2093
- Любченко А. В., см. Вирт И. С. 3, 409
- Ляпилин И. И., см. Карягин В. В. 5, 957
- Ляпилин И. И., см. Карягин В. В. 8, 1503
- Ляпин А. Г., см. Демисhev С. В. 9, 1666
- Мазур Е. А., см. Корнеева Л. А. 10, 1859
- Макаренко В. Г., см. Баранский П. И. 1, 158
- Маковецкая Л. А., см. Аксенов И. А. 5, 961
- Максименко В. М., см. Бабич В. М. 5, 956
- Малевиц В. Л., см. Баязитов Р. М. 1, 79
- Малевиц В. Л., см. Гацкевич Е. И. 4, 697
- Молозовский Ю. М., см. Малютенко В. К. 2, 345
- Молозовский Ю. М., см. Малютенко В. К. 8, 1497
- Мальханов С. Е., см. Колесников Н. В. 3, 534
- Малышев С. А., см. Кушир П. Г. 4, 582
- Малютенко В. К., Малошовский Ю. М. Междузонное тепловое излучение полупроводников. 2, 345
- Малютенко В. К., Малошовский Ю. М. *N*-ОДП при пинч-эффекте в неособенных полупроводниках. 8, 1497
- Малютенко В. К., Яблоновский Е. И., Савченко А. П., Билинец Ю. Ю., Кабацкий В. Н. Люминесценция InAs в условиях магнитной инжекции. 4, 593
- Малютенко В. К., см. Акоюн А. А. 3, 471
- Малютенко В. К., см. Алмазов Л. А. 8, 1337
- Малютенко В. К., см. Гуга К. Ю. 8, 1490
- Маляренко А. М., см. Берман Л. С. 5, 844
- Мамедов З. Г., см. Гусейнов Д. Т. 5, 956
- Мамонтов А. П., см. Войцеховский А. В. 12, 2226
- Мамутин В. В., см. Гореленок А. Т. 1, 35
- Манассон В. А., Комиссаров Г. П. Эффект термостимулированного переключения в туннельной ПДП структуре. 7, 1322
- Манассон В. А., см. Баранюк В. В. 4, 733
- Мансфельд Г. Д., см. Веретин В. С. 11, 1924
- Марджов А. С., Серяпин В. Г., Швеиц В. А. Профили показателей преломления и поглощения в кремнии, имплантированном ионами фосфора. 7, 1306
- Марквич В. П., Мурип Л. И. Селективный захват междуатомных атомов углерода в облученном кремнии. 5, 911
- Маркевич В. П., см. Мурип Л. И. 7, 1324

- Маркин Ю. В., см. Гольдман Е. И. 2, 237
- Марков А. В., Омельяновский Э. М., Освенский В. Б., Поляков А. Я., Ковальчук И. А., Райхштейн В. И., Тишкин М. В. Влияние дислокаций на распределение глубоких центров в полуизолирующем GaAs. 1, 44
- Марков А. В., см. Картавых А. В. 9, 1702
- Мармур И. Я., Новиков Ю. Б., Оксман Я. А. Фотоемкостной эффект на запертых  $p-n$ -переходах. 1, 87
- Мармур И. Я., Оксман Я. А. Релаксация фотоинжектированных носителей в германиевых  $p-n$ -переходах. 3, 525
- Мартисов М. Ю., Шик А. Я. Примесное рассеяние и межузровневые переходы в двумерных электронных системах. 6, 1075
- Мартисов М. Ю., см. Крещук А. М. 4, 604
- Мартунас З., см. Дедуевич С. 4, 744
- Мартынюк А. Н., см. Земсков Б. Г. 5, 934
- Марущак В. А., см. Журавлев А. Б. 2, 352
- Марущак В. А., см. Пикус Г. Е. 2, 185
- Марущак Н. В., см. Афонин О. Ф. 1, 56
- Марцинкявичюс С., Амбразевичус Г., Бекимбетов Р. Н., Медведкин Г. А. Оптические свойства  $MnIn_2Te_4$  и  $MnGa_2Te_4$ . 11, 1919
- Марьянчук П. Д., см. Исмаилов Ж. Т. 3, 375
- Маслов А. Ю., см. Козырев С. В. 3, 433
- Мастеров В. Ф., Харченко В. А., Хохрякова О. Д. О резонансном рассеянии электронов в полупроводниках, легированных редкоземельными элементами. 1, 118
- Мастеров В. Ф., Штельмах К. Ф., Барбашов М. Н. ЭПР связанных дырок в GaAs(Mn). 4, 654
- Мастеров В. Ф., см. Васильев А. Э. 7, 1253
- Матвеев Б. А., Петров В. И., Стусь Н. М., Талалакин Г. Н., Шабалин В. В. Католюминесценция градиентных эпитаксиальных структур InAsSbP/InAs. 7, 1244
- Матвеев Г. А., Цидильковский И. М., Лончаков А. Т., Брандт Н. Б., Кульбачинский В. А. Низкотемпературные особенности явления переноса в  $n-Ge$  вблизи перехода металл-диэлектрик. 5, 799
- Матвеев Г. А., см. Лончаков А. Т. 5, 839
- Матвеев Г. А., см. Лончаков А. Т. 8, 1396
- Материкин Д. И., см. Захаров Ю. В. 3, 485
- Матов О. Р., см. Галченков Л. А. 7, 1196
- Матулис А., см. Дедуевич С. 5, 881
- Махкамов Ш., см. Мирзаев А. 7, 1177
- Махмудов А. Ш. Происхождение глубоких уровней примесей непереходных элементов в кремнии и германии. 8, 1479
- Махний В. П., см. Горбенко Н. В. 9, 1651
- Махний В. П., см. Кабанова И. С. 10, 1852
- Маонашвили Б. П., см. Засавицкий И. И. 12, 2118
- Машина А. И., см. Хохлов А. Ф. 8, 1511
- Машина Н. И., см. Хохлов А. Ф. 8, 1511
- Машкевич О. Л., см. Бочков А. В. 4, 764
- Машкевич О. Л., см. Гуревич Ю. Г. 11, 1955
- Машовец Т. В., см. Абдусаттаров А. Г. 3, 502
- Машовец Т. В., см. Витовский Н. А. 8, 1483
- Машовец Т. В., см. Емцев В. В. 5, 924
- Медведев Б. А., см. Галченков Л. А. 7, 1196
- Медведев Л. С., см. Еремин В. К. 7, 1239
- Медведкин Г. А., см. Марцинкявичюс С. 11, 1919
- Мездрогина М. М., см. Регель А. Р. 1, 161
- Мездрогина М. М., см. Регель А. Р. 10, 1856
- Мездрогина М. М., см. Стриха В. И. 3, 461
- Мезрин О. А., Трошков С. И. Диффузия горячих фотоэлектронов в металл — эффективный механизм потерь в фотоэлементах с барьером Шоттки. 1, 176
- Мезрин О. А., см. Акулова Ю. А. 7, 1287
- Мезрин О. А., см. Константинов О. В. 1, 129
- Мезрин О. А., см. Константинов О. В. 11, 2025
- Мельник Р. Б., см. Вейс А. П. 1, 171
- Мельников А. П., см. Ждан А. Г. 6, 1011
- Мельникова Ю. С., см. Конакова Р. В. 10, 1754
- Мельничук С. В., Курек И. Г. Зонная структура и плотность состояний ZnSe, ZnTe, CdTe с учетом  $d$ -состояний металла в методе сильной связи.\* 9, 1719
- Мельцер Б. Я., см. Ивченко Е. Л. 5, 784
- Меркулов И. А., см. Иванов М. Г. 4, 628
- Мехтиев Н. М., Алиев Г. М., Гусейнов З. З. Зарядовое состояние рекомбинационных центров в  $ZnIn_2Se_4$ . 10, 1882
- Мехтиев Н. М., Гусейнов З. З. Уровни прилипания для электронов в  $ZnIn_2Se_4$ . 4, 700
- Мепков А. М., см. Винников А. Я. 3, 390
- Мизрухин Л. В., см. Крайчинский А. П. 2, 215
- Милешкина Н. В., Семькина Е. А. Численное моделирование приповерхностных потенциалов и анализ размерных эффектов в сильном электрическом поле.\* 5, 955
- Милчевич Е. П., см. Болд З. 12, 2173
- Мильвидский М. Г., см. Бабицкий Ю. М. 2, 307
- Мильвидский М. Г., см. Брук А. С. 10, 1792

- Мильвидский М. Г., см. Картавых А. В. 6, 1004
- Мильвидский М. Г., см. Картавых А. В. 11, 2035
- Миляев В. А., см. Дашевский М. Я. 6, 1146
- Мишаев Т. А., см. Берковиц В. Л. 1, 66
- Минина Н. Я., см. Богданов Е. В. 8, 1348
- Миньков Г. М., см. Германенко А. В. 6, 992
- Миньков Г. М., см. Германенко А. В. 7, 1158
- Миргородский В. И., Пешин С. В. Акустоэлектронное затухание в условиях нестационарной фотопроводимости в сульфиде кадмия. 8, 1486
- Мирзаев А., Махкамов Ш., Турсунов Н. А. Радиационное дефектообразование в кремнии, легированном палладием. 7, 1177
- Мирлин Д. Н., см. Алексеев М. А. 4, 569
- Миринов К. Е., см. Баженов Н. Л. 7, 1258
- Михнович В. В., см. Артемьев В. А. 2, 243
- Михнович В. В., см. Артемьев В. А. 4, 750
- Михнович В. В., см. Артемьев В. А. 5, 953
- Михнович В. В., см. Артемьев В. А. 5, 954
- Михнович В. В., см. Артемьев В. А. 5, 955
- Михнович В. В., см. Васильев А. В. 6, 1137
- Мишкинис Р. А., см. Бразис Р. С. 9, 1689
- Мовилэ В. Ф., см. Баженов Н. Л. 7, 1258
- Моздор Е. В., Прима Н. А. Размерный эффект на кинетических длинах в магнитопротивлении многодолинных полупроводников. 7, 1291
- Моздор Е. В., см. Конакова Р. В. 10, 1754
- Мозоль П. Е., Скубенко Н. А., Скубенко П. А., Гнатенко Ю. П., Сальков Е. А., Ковалюк Э. Д. Влияние лазерного облучения на низкотемпературные спектры фотопроводимости и фотолуминесценции селенида галлия. 9, 1595
- Мокиров В. Г., см. Галченков Л. А. 7, 1196
- Монахов А. М., см. Левин Е. И. 3, 450
- Мопозон В. С., Селезнева А. Н. Многофотонное электропоглощение в полупроводниках с вырожденной валентной зоной. 11, 2046
- Мордкович В. Н., см. Итальянцев А. Г. 5, 834
- Мороз С. Е., см. Кольченко Т. И. 4, 740
- Мороз С. Е., см. Кольченко Т. И. 7, 1311
- Морозенко Я. В., см. Вишневская Б. И. 4, 664
- Мукашев Б. Н., Токмолдин С. Ж., Тамендаров М. Ф., Абдуллин Х. А., Чихрай Е. В. Пассивация примесей и радиационных дефектов водородом в кремнии р-типа. 6, 1020
- Мукашев Б. Н., см. Абдулгафаров С. Е. 7, 1171
- Мукашев Б. Н., см. Колодин Л. Г. 5, 821
- Мукашев Б. Н., см. Фролов В. В. 3, 1715
- Мурин Л. И., Маркевич В. П. Образование термодоноров и механизм ускоренной диффузии кислорода в кремнии. 7, 1324
- Мурин Л. И., см. Маркевич В. П. 5, 911
- Мурина Т. М., см. Батунина А. В. 7, 1308
- Мурина Т. М., см. Калинушкин В. П. 6, 1112
- Мусаев А. М., см. Баширов Р. И. 3, 479
- Мусалитин А. М., см. Скипстров Е. П. 10, 1785
- Мусихин С. Ф., см. Бакуева Л. Г. 8, 1495
- Мусихин С. В., см. Бакуева Л. Г. 10, 1896
- Мустафаев А. А., см. Гашимов Г. И. 2, 282
- Мынбаев К. Д., см. Баженов Н. Л. 2, 333
- Мякенькая Г. С., см. Гуцев Г. Л. 7, 1153
- Мякенькая Г. С., см. Гуцев Г. Л. 7, 1219
- Мясников А. М., см. Герасименко Н. Н. 4, 753
- Набиев Р. Ф., см. Лаврушин Б. М. 4, 710
- Нажмудинов Х. Г., см. Шаронова Л. В. 1, 93
- Назарчук П. Ф., см. Семенюк А. К. 9, 1716
- Налбандян Л. В., см. Витовский Н. А. 7, 1316
- Налет Т. А., см. Алфёров Ж. И. 6, 1031
- Наливайко И. И., см. Омеляновский Э. М. 12, 2217
- Насибов А. С., см. Бушуева Г. В. 2, 201
- Насрединов Ф. С., см. Регель А. Р. 1, 161
- Насрединов Ф. С., см. Регель А. Р. 6, 1144
- Науменко Г. Ю., см. Зудеев О. Г. 5, 938
- Наурзалин Р. Е., см. Абдулгафаров С. Е. 7, 1171
- Нахабин А. В., см. Баженов В. К. 1, 179
- Неизвестный И. Г., см. Васин О. И. 7, 1299
- Неймах В. Б., Соснин М. Г., Шаховцов В. И., Шиндич В. Л., Ясковец И. И. Рекомбинация в n-Si при термообработке и облучении. 2, 206
- Немов С. А., Равич Ю. И. Плотность резонансных состояний по данным термоэдс в РbTe<math>\langle\text{TI}\rangle</math>. 8, 1370
- Немов С. А., см. Вейс А. Н. 1, 171
- Немов С. А., см. Житинская М. К. 11, 2043
- Нестеров А. А., см. Герасименко Н. Н. 4, 753
- Неустроев Л. Н. К теории эффекта Холла в сетке инверсионных каналов. 4, 773

- Неустроев Л. Н., см. Кондратьева О. Г. 12, 2131
- Нефедов И. М., см. Алешкин В. Я. 11, 1910
- Нздаев Е. В., Васильев А. Л. Эпитаксиальная кристаллизация аморфного кремния, стимулированная лазерным излучением. 7, 1190
- Никитенко В. Р., см. Архипов В. И. 3, 419
- Никитенко В. Р., см. Архипов В. И. 3, 544
- Никитин В. А., см. Дашевский М. Я. 6, 1146
- Никитин М. С., см. Аронзон Б. А. 5, 897
- Никифоров В. П., см. Показной И. И. 6, 1108
- Николаев М. В., см. Зудеев О. Г. 5, 938
- Николаева Л. Г., см. Гроза А. А. 12, 2244
- Никоноров В. В., см. Баширов Р. И. 3, 479
- Никоноров В. В., см. Гавриленко В. И. 7, 1233
- Николюк Е. С., см. Золотарев С. В. 6, 1062
- Никорич А. В., см. Акимов Б. А. 2, 248
- Новиков С. В., см. Амуся В. М. 2, 342
- Новиков С. В., см. Голубев Л. В. 11, 1948
- Новиков С. Р., см. Котина И. М. 12, 2165
- Новиков Ю. Б., см. Мармур И. Я. 1, 87
- Новрузов В. Д., см. Байрамов А. И. 9, 1716
- Норцева Н. В., см. Аверьянов В. Л. 11, 2093
- Носенко С. В., см. Ковешников С. В. 5, 922
- Няткишис В., см. Балтрамеюнас Р. 8, 1422
- Ободников В. И., см. Герасименко Н. Н. 4, 753
- Обухов С. А. Переход металл—диэлектрик в кристаллах антимонида индия, легированных марганцем. 1, 31
- Овчаров В. В., см. Беда А. Г. 11, 2065
- Огинская А. К., см. Чеснис А. А. 6, 1132
- Огненский А. И., см. Дмитренко Н. Н. 10, 1769
- Огородников В. К., см. Баженов Н. Л. 2, 333
- Окомельков А. В., см. Генкин Г. М. 6, 1085
- Окомельков А. В., см. Генкин Г. М. 12, 2151
- Оксман Я. А., см. Мармур И. Я. 1, 87
- Оксман Я. А., см. Мармур И. Я. 3, 525
- Окунев В. Д., Пафомов Н. Н. Электрическая активность Ni в стеклообразном CdGeAs<sub>2</sub>. 3, 497.
- Олеск С. А., см. Анисимова Н. П. 9, 1590
- Ольшанецкий Е. В., см. Быков А. А. 9, 1706
- Омельяновский Э. М., Пахомов А. В., Поляков А. Я. Пассивация мелких доноров в фосфиде индия атомарным водородом. 10, 1892
- Омельяновский Э. М., Пахомов А. В., Поляков А. Я., Бородина О. М., Наливайко И. И. К вопросу о механизме пассивации мелких доноров в арсениде галлия атомарным водородом. 12, 2217
- Омельяновский Э. М., Пахомов А. В., Поляков А. Я., Горюков А. В., Бородин О. М., Брук А. С. Факторы, определяющие профиль пассивации дефектов при введении атомарного водорода в GaAs. 7, 1203
- Омельяновский Э. М., см. Балагуров Л. А. 1, 155
- Омельяновский Э. М., см. Балагуров Л. А. 1, 168
- Омельяновский Э. М., см. Балагуров Л. А. 11, 1967
- Омельяновский Э. М., см. Маркин А. В. 1, 44
- Орлов Б. Б., см. Алфёров Ж. И. 12, 2111
- Орлов Л. К., Кузнецов О. А. Фотовольтаический эффект в структурах, содержащих сверхрешетки Ge—Ge<sub>1-x</sub>Si<sub>x</sub>. 11, 1994
- Освенский В. Б., см. Глориозова Р. И. 3, 507
- Освенский В. Б., см. Колин Н. Г. 6, 1025
- Освенский В. Б., см. Маркин А. В. 1, 44
- Осипов В. В., см. Гафийчук В. В. 10, 1836
- Осипов В. В., см. Гафийчук В. В. 11, 2051
- Осипов В. В., см. Кондратьева О. Г. 12, 2131
- Осташко Н. И., см. Крайчинский А. Н. 2, 215
- Осташко С. А., см. Балагуров Л. А. 1, 168
- Остробородова В. В., см. Ковалев А. Н. 9, 1601
- Остроумов В. И., Соловьев Г. Г., Труфанов А. И. Прогнозирование радиационных изменений электропроводности кремния в области значений поглощенных доз до 500 кГр. 7, 1273.
- Осути А. В., см. Голубев В. Г. 8, 1416
- Охонин С. А., Погосов А. Г., Французов А. А. Исследование туннелирования электронов в МОП структурах в области перехода от трапецидального барьера к треугольному. 5, 811
- Охрем Е. А., см. Буда И. С. 5, 957
- Павлов Б. В., см. Аверьянов В. Л. 11, 2093
- Павлов Д. А., Пищулина И. В., Хохлов А. Ф. Влияние примеси углерода на свойства аморфного кремния. 5, 929
- Павлов Д. А., Хохлов А. Ф., Кудрявцева Р. В., Ершов А. В. Влияние изovalентных примесей на структуру и свойства аморфного кремния. 12, 2187
- Палкин А. М., см. Курбанов К. Р. 8, 1509
- Панасюк Л. И., см. Федосов А. В. 7, 1297
- Панахов М. М., см. Аскеров Б. М. 6, 1104
- Панин Г. Н., см. Брайтенштайн О. 9, 1687

- Панов В. И., Смирнов Л. С., Харьков А. А. К теории анизотропии пороговой энергии образования первичных радиационных дефектов в кристаллах.\* 12, 2243
- Панов В. И., см. Айтин А. И. 4, 692
- Панов В. И., см. Антонова И. В. 6, 998
- Панченко О. Ф., Шаталов В. М. Энергетическое распределение сильно неравновесных носителей в кремнии.\* 9, 1720
- Пардаев А. П., см. Гальперин Ю. М. 5, 915
- Пафомов Н. Н., см. Окунов В. Д. 3, 497
- Пахомов А. В., см. Омеляновский Э. М. 7, 1203
- Пахомов А. В., см. Омеляновский Э. М. 10, 1892
- Пахомов А. В., см. Омеляновский Э. М. 12, 2217
- Пашковский А. Б., см. Кальфа А. А. 11, 2090
- Пека Г. П., Кавалюскас А. А., Пулеметов Д. А., Смоляр А. Н., Шимулите Е. А. Селективная фоточувствительность длинных  $p^+$ - $n$ -диодов с варизонной базой на основе  $Al_xGa_{1-x}As$ . 4, 618
- Пека Г. П., Пулеметов Д. А., Радзивилук В. А., Смоляр А. Н., Шимулите Е. А. Фоточувствительность длинных диодов структур на основе варизонных твердых растворов  $Al_xGa_{1-x}As$ . 1, 150
- Пека Г. П., см. Ковалюскас А. А. 12, 2177
- Пендюр С. А., см. Бушуева Г. В. 2, 201
- Первова Л. Я., см. Ванер Р. А. 2, 255
- Первое информационное сообщение. 1, 181
- Перга В. М., см. Калитенко В. А. 4, 578
- Перель В. И., см. Абакумов В. Н. 2, 262
- Пермяков Ю. В., см. Земсков Б. Г. 5, 934
- Перов П. И., см. Поляков В. И. 8, 1446
- Першеев С., см. Алибаев А. С. 3, 566
- Першеев С. К., см. Абдурахманов К. П. 11, 2088
- Петиков Н. И., см. Васин О. И. 7, 1299
- Петришин А. А., см. Шеховцов Н. А. 5, 958
- Петров А. С., см. Войцеховский А. В. 12, 2226
- Петров В. В., см. Латушко Я. И. 12, 2247
- Петров В. И., см. Матвеев Б. А. 7, 1244
- Петров П. И., см. Дугаев В. К. 3, 519
- Петросян С. Г., Шика Я. Влияние флуктуаций состава и легирования на неравновесные свойства полупроводника. 12, 2192
- Петухов А. Г. Двухузельная модель биполярона малого радиуса. 3, 527
- Печенов А. Н., см. Бушуева Г. В. 2, 201
- Пешев В. В., см. Брудный В. Н. 6, 1124
- Пешин С. В., см. Миргородский В. И. 8, 1486
- Пикус Г. Е., Марущак В. А., Титков А. Н. Спиновое расщепление зон и спиновая релаксация носителей в кубических кристаллах  $A^{11}BV$  (обзор). 2, 185
- Пикус Ф. Г. Сдвиговый фотогальванический эффект в полупроводниках со сверхрешеткой без центра инверсии. 5, 940
- Пинскер Т. Н., см. Балагуров Л. А. 1, 155
- Пинскер Т. Н., см. Гродневский И. М. 7, 1223
- Пила В. И. Концентрация свободных электронов в полупроводнике в условиях дефицита фотонов. 3, 553
- Питанов В. С., см. Абляимова Н. А. 11, 2001
- Пихтин А. Н., Попов В. А., Юнис М. Фотоэффект, индуцированный эффектом Штарка на связанном экситоне в GaP: N. 6, 1107
- Пихтин А. Н., Яськов А. Д. Рефракция света в полупроводниках (обзор). 6, 969
- Пицалко В. Д., Толстихин В. И. Влияние разогрева носителей на токи утечки в ДГС InGaAsP/InP. 9, 1617
- Пицалко В. Д., Толстихин В. И. Подавление динамического эффекта Бурштейна—Мосса оже-разогревом и безрезонаторная оптическая бистабильность в InGaAsP. 11, 2014
- Пищев А. Г., см. Кристофель Н. Н. 4, 742
- Пищулина И. В., см. Павлов Д. А. 5, 929
- Плотицын А. Е., см. Гуткин А. А. 8, 1387
- Плявенец А. Г., см. Журавлев А. Б. 7, 1208
- Погосов А. Г., см. Охонин С. А. 5, 811
- Подсекалов И. Н., см. Скипетров Е. П. 10, 1785
- Пожеда Ю., см. Галванаускас А. 9, 1672
- Пожеда Ю. К., Сталерайтис К. К. К вопросу об эффекте изменения электропроводности полупроводника в неоднородном магнитном поле. 5, 949
- Позолотин В. А., см. Гермогенов В. П. 4, 623
- Позолотин В. А., см. Гермогенов В. П. 5, 849
- Показной И. И., Шишияну Ф. С., Тигиняну И. М., Никифоров В. П., Шонта В. П. Влияние давления паров мышьяка на свойства нелегированного полужолирирующего GaAs при термообработке. 6, 1108
- Поклонский Н. А., см. Доросинцев В. А. 4, 761
- Покоева В. А. Одновременная диффузия двух заряженных примесей в полупроводнике с учетом внутреннего электрического поля.\* 12, 2246
- Полоскин Д. С., см. Витовский Н. А. 7, 1316
- Полоскин Д. С., см. Витовский Н. А. 8, 1483
- Полупанов А. Ф., Таскинбоев Р. Влияние гофрировки валентных зон на энергию  $\Gamma_4$ -уровней мелких акцепторов в кубических полупроводниках. 1, 112
- Поляков А. Я., см. Маркин А. В. 1, 44
- Поляков А. Я., см. Омеляновский Э. М. 7, 1203
- Поляков А. Я., см. Омеляновский Э. М. 10, 1892
- Поляков А. Я., см. Омеляновский Э. М. 12, 2217
- Поляков В. И., Перов П. И., Ермаков М. Г., Ермакова О. Н., Сергеев В. И. Особенности фото-





- железом аморфного гидrogenизированного углерода. 10, 1856
- Регель А. Р., Серегин П. П., Мездрогина М. М., Насрединов Ф. С., Аблова М. С., Абдуманапов У. Ж. Природа примесных состояний, образуемых переходными металлами (железом и европием) в аморфном гидрированном кремнии. 1, 161
- Регель А. Р., Серегин П. П., Насрединов Ф. С., Агзамов А. А. Двухэлектронные центры олова в  $\text{In}_2\text{S}_3$ . 6, 1144
- Резников Б. И., Стамкулов А. А., Таурбаев Т. И., Царенков Б. В., Царенков Г. В. Гетероваризонный GaAlAs-фотоэлемент — спектральный аналог глаза. I. Модель. 9, 1634
- Резников Б. И., Стамкулов А. А., Таурбаев Т. И., Царенков Б. В., Царенков Г. В. Гетероваризонный GaAlAs-фотоэлемент — спектральный аналог глаза. II. Эксперимент. 9, 1640
- Резников Б. И., Царенков Г. В. Распространение импульса неравновесных носителей заряда в варизонном полупроводнике при произвольных уровнях возбуждения. 4, 704
- Реклайтис А., см. Галванаускас А. 9, 1672
- Рембеза С. И., см. Захаров Ю. В. 3, 485
- Ременюк А. Д., см. Берман Л. С. 5, 844
- Ременюк А. Д., см. Берман Л. С. 12, 2169
- Решетов В. И., см. Бушуева Г. В. 2, 201
- Решиков М. А., см. Гуткин А. А. 8, 1387
- Рогачев А. А., см. Левин Е. И. 3, 450
- Родкин В. С., см. Вишневская Б. И. 4, 664
- Рожков А. В., см. Григорьев Б. И. 3, 413
- Розанов Н. Н., см. Аршев И. П. 6, 1068
- Романов В. А., см. Гузь В. Н. 10, 1864
- Романов В. А., см. Жадько И. П. 7, 1185
- Романов О. Г., см. Довбыш Л. Е. 2, 359
- Романов Ю. А., см. Алешкин В. Я. 11, 1910
- Романюк Б. Н., см. Артамонов В. В. 11, 1961
- Россин В. В., см. Жилиев Ю. В. 10, 1885
- Россин В. В., см. Королев В. Л. 3, 532
- Россина Т. В., см. Жилиев Ю. В. 10, 1885
- Рубинова Э. Э., см. Итальянцев А. Г. 5, 834
- Рубцов В. А., см. Аксенов И. А. 5, 961
- Рудайтис В. Г., см. Конин А. М. 7, 1283
- Руденко А. И., см. Архипов А. И. 2, 276
- Руденко А. И., см. Архипов В. И. 3, 544
- Руденко А. И., см. Архипов В. И. 4, 723
- Руденко А. И., см. Корнеева Л. А. 10, 1859
- Руденко Т. Е., см. Литовский Р. Н. 5, 875
- Руднев Е. В., см. Сысоев Б. И. 10, 1871
- Рудской И. В., см. Артамонов В. В. 11, 1961
- Рудь Ю. В., см. Бекимбетов Р. Н. 6, 1101
- Рудь Ю. В., см. Константинова Н. Н. 9, 1580
- Рудь Ю. В., см. Константинова Н. Н. 9, 1699
- Рудь Ю. В., см. Лунев А. В. 6, 1115
- Рузин И. М., см. Левин Е. И. 4, 642
- Рузин И. М., см. Райх М. Э. 7, 1262
- Рузин И. М., см. Райх М. Э. 11, 1979
- Руйбис Г. С., Голдтис Р. Б. О существовании медленных поверхностных волн геликонного типа. 3, 516
- Руменин Ч. С. Роль шунтирования тока в магниточувствительности планарных магнитотранзисторов. 9, 1647
- Румянцев В. Д., см. Алфёров Ж. И. 10, 1775
- Румянцев Е. Л., Рут О. Э. Особенности спектра одноосно деформированных полупроводников с вырожденными зонами в магнитном поле, перпендикулярном давлению. 8, 1341
- Румянцев Е. Л., см. Германенко А. В. 7, 1158
- Румянцев С. Л., см. Дьяконова Н. В. 6, 1049
- Рустамов А. Г., см. Гашимов Г. И. 2, 282
- Рут О. Э., см. Германенко А. В. 6, 992
- Рут О. Э., см. Германенко А. В. 7, 1158
- Рут О. Э., см. Емлин Р. В. 2, 269
- Рут О. Э., см. Румянцев Е. Л. 8, 1341
- Рутковский И. З., см. Кучинский П. В. 4, 634
- Рутковский П. Ф., см. Бразис Р. С. 9, 1689
- Рыжий В. И., Хмырова И. И. Эффект вытеснения тока в гетероструктурных транзисторах на горячих электродах. 7, 1277
- Рыжиков В., см. Балтрамеюнас Р. 7, 1163
- Рыжков М. П., см. Кушир П. Г. 4, 582
- Рыльков В. В. Захват дырок на отрицательно заряженные атомы бора в легированном слабо компенсированном кремнии при низких температурах. 9, 1661
- Рыльков В. В., см. Веденев А. С. 4, 586
- Рыльков В. В., см. Ждан А. Г. 6, 1011
- Рытова Н. С., см. Картавых А. В. 6, 1004
- Рябова Л. И., см. Акимова Б. А. 2, 248
- Саава С. Э., см. Городецкий М. Л. 11, 2080
- Сабирзянова Л. Д., см. Глузман Н. Г. 7, 1321
- Саблюков В. А., см. Карпова И. В. 4, 609
- Савельев И. Г., Полянская Т. А. Высокотемпературные квантовые поправки к проводимости двумерного электронного газа в AlGaAs/GaAs. 10, 1818
- Савельев И. Г., см. Голубев Л. В. 11, 1948
- Савельев И. Г., см. Гореленок А. Т. 1, 35
- Савельев И. Г., см. Крещук А. М. 4, 604
- Савельев И. Г., см. Крещук А. М. 12, 2162
- Савицкий А. В., см. Савчук А. И. 3, 512

- Савостьянов А. В., см. Веденев А. С. 7, 1199
- Савостьянов А. В., см. Катков Б. М. 5, 959
- Савченко А. П., Жигулин С. Н. Определение диффузионной длины неосновных носителей заряда методом электромультивированной фотолюминесценции. 3, 550
- Савченко А. П., см. Малышенко В. К. 4, 593
- Савчук А. И., Деркач Б. Е., Ватаманюк П. П., Савицкий А. В., Ульяницкий К. С. Особенности дисперсии фарадеевского вращения в полупроводниках. 3, 512
- Сагдуллаев Х. У., см. Абдурахманов К. П. 3, 510
- Сазонов А. В., см. Засавицкий И. И. 12, 2118
- Сайнов Н. А., см. Баязитов Р. М. 1, 79
- Сайдашев И. И., см. Голубев Л. В. 11, 1948
- Сайдашев И. И., см. Крещук А. М. 4, 604
- Сайдашев И. И., см. Крещук А. М. 12, 2162
- Сакалас П., см. Барейкис В. 6, 1040
- Салиева О. К., см. Андреев В. М. 8, 1391
- Салихов Х. М., см. Андрушко А. И. 5, 789
- Салихов Х. М., см. Андрушко А. И. 8, 1528
- Салманов А. Р., см. Блецкан Н. И. 12, 2223
- Салмин Е. А., Пономаренко В. П., Стафеев В. И. Полевой транзистор со структурой МТДП на основе  $Cd_xHg_{1-x}Te$ . 6, 1142
- Сальков Е. А., см. Бакши И. С. 12, 2182
- Сальков Е. А., см. Мозоль П. Е. 9, 1595
- Сальков Е. А., см. Тарбаев Н. И. 8, 1428
- Самарин С. Н., см. Артамонов О. М. 4, 638
- Саморуков Б. Е., см. Ворошица Т. И. 1, 147
- Саморуков Б. Е., см. Гуткин А. А. 8, 1387
- Самуйлов В. А., см. Доросинец В. А. 4, 761
- Сандомирский В. Б., Федорова М. Б., Филатов А. П. Фототермический эффект в полупроводнике в поле переменной деформации. 12, 2209
- Санкин В. И., см. Верещикова Р. Г. 9, 1692
- Сапегга В. Ф., см. Алексеев М. А. 4, 569
- Сарбей О. Г., см. Васецкий В. М. 9, 1610
- Сарбей О. Г., см. Гигуашвили Г. В. 6, 1053
- Сарсембинов Ш. Ш., см. Аверьянов В. П. 11, 2093
- Саркисян Э. С., см. Васецкий В. М. 9, 1610
- Сафаров В. И., см. Берковиц В. Л. 1, 66
- Сафонова Л. С., см. Бразис Р. С. 2, 320
- Сафронов Л. Н., см. Герасименко Н. Н. 4, 753
- Саченко А. В., см. Попов В. Г. 10, 1867
- Саченко А. В., см. Прима Н. А. 3, 522
- Сащук А. П., см. Кониц А. М. 7, 1283
- Свелокучов А. Е., см. Гарбузов Д. З. 4, 657
- Свердлов В. А., см. Кучма А. Е. 8, 1500
- Свешников А. А., см. Капустин Ю. А. 9, 1708
- Седельников А. Э., см. Попомарев В. Н. 9, 1563
- Селенский О. А., см. Бочкарев В. В. 5, 960
- Сейсян Р. П., Якобсон М. А. Зеленая люминесценция  $CdS$  в поле барьера Шоттки. 7, 1304
- Сейсян Р. П., см. Голубев В. Г. 8, 1416
- Селезнева А. П., см. Монозон Б. С. 11, 2046
- Семашко Е. М., см. Крещук А. М. 12, 2162
- Семенов Ю. Г., см. Беляев А. Е. 2, 335
- Семенов Ю. Г., см. Зарицкий И. М. 3, 402
- Семениук А. К., Назарчук П. Ф. Об изменении энергии ионизации  $\gamma$ -радиационных дефектов в  $n$ -Ge при одноосной деформации.\* 9, 1716
- Семиколонова Н. А. Поляритоны в арсениде галлия  $n$ -типа. 1, 137
- Семькина Е. А., см. Милешкина Н. В. 5, 955
- Сеничкин А. П., см. Алфёров Ж. И. 12, 2105
- Сергеев В. И., см. Поляков В. И. 8, 1446
- Сердега Б. К., см. Григорьев Н. Н. 10, 1764
- Сердега Б. К., см. Жадько И. П. 7, 1185
- Сердюк В. В., см. Борцак В. А. 3, 561
- Серегин В. Ф., см. Куравлев А. Б. 7, 1208
- Серегин П. П., см. Регель А. Р. 1, 161
- Серегин П. П., см. Регель А. Р. 6, 1144
- Серегин П. П., см. Регель А. Р. 10, 1856
- Серяпин В. Г., см. Мардежов А. С. 7, 1306
- Сидорин В. В. Бесконтактное измерение концентрации и подвижности свободных носителей заряда в полупроводниках. 9, 1680
- Сидоров В. Г., см. Королев В. Л. 3, 532
- Сидоров В. Г., см. Королев В. Л. 8, 1359
- Сидоров В. Г., см. Королев В. Л. 10, 1827
- Сизов Ф. Ф., см. Троян Ю. Г. 8, 1408
- Симашкевич А. А., см. Архипов В. И. 2, 276
- Симашкевич А. В., см. Коваль А. В. 5, 932
- Синдер М. И. Кинетика установления асимптотических диффузионных примесных профилей в полупроводниках.\* 5, 953
- Синицын М. А., см. Алфёров Ж. И. 12, 2111
- Снябеков Х. Б., см. Алибаев А. С. 3, 565
- Снябеков Х. Б., см. Алибаев А. С. 3, 566
- Скипетров Е. П., Дубков В. П., Мусалитин А. М., Подсекалов И. Н. Проводимость по локальной

- зоне в сплавах  $Pd_{1-x}Sn_xSe$ , облученных электронами. 10, 1785
- Скипетров Е. П., см. Брандт Н. Б. 8, 1462
- Скипетров Е. П., см. Брандт Н. Б. 8, 1469
- Скороходов А. Б., см. Алфёров Ж. И. 12, 2105
- Скороцкая Г. Г., см. Демишев С. В. 9, 1666
- Скрышевский В. А., см. Попов В. Г. 10, 1867
- Скубенко Н. А., см. Мозоль П. Е. 9, 1595
- Скубенко П. А., см. Мозоль П. Е. 9, 1595
- Скубневский Э. В., см. Курбанов К. Р. 8, 1509
- Слободчиков С. В., см. Андрушко А. И. 5, 789
- Слободчиков С. В., см. Андрушко А. И. 8, 1528
- Случанко Н. Е., см. Демишев С. В. 9, 1666
- Смагулова С. А., см. Васильев А. В. 6, 1137
- Смирнов В. В., см. Колодин Л. Г. 5, 821
- Смирнов И. Н., Бахтиярова М. В., Филатова Е. О. Смещение электронных оболочек фосфора в полупроводниковых структурах на основе кремния. 2, 357
- Смирнов Л. С., см. Болотов В. В. 2, 210
- Смирнов Л. С., см. Панов В. И. 12, 2243
- Смоляр А. Н., см. Кавалаяускас А. А. 12, 2177
- Смоляр А. Н., см. Пека Г. П. 1, 150
- Смоляр А. Н., см. Пека Г. П. 4, 618
- Снарский А. А. О проводимости макроскопически неоднородных полупроводниковых пленок вблизи порога протекания в наклонном магнитном поле. 11, 2073
- Соболев Н. А., см. Выжигин Ю. В. 3, 536
- Соболев Н. А., см. Коршунов Ф. П. 10, 1850
- Соколов В. Д., см. Доцанов К. М. 3, 564
- Соколов В. Н., см. Зюзин А. Ю. 2, 341
- Соколов В. Н., см. Кочелап В. А. 5, 868
- Соколов И. А., см. Якимчук Д. Ю. 8, 1474
- Соколова З. Н., Халфип В. Б., Эфрос Ал. Л. Размерное квантование дырок и особенности экситонных спектров в квантовой яме конечной глубины. 12, 2124
- Соколова З. Н., см. Гарбузов Д. З. 6, 1035
- Соколюк Д. В., см. Баранский П. И. 11, 2069
- Соловьев А. В., см. Герчиков Л. Г. 9, 1710
- Соловьев В. А., см. Андреев В. М. 8, 1391
- Соловьев В. Н., Хрисанов В. А. Флуктуации локальных атомных потенциалов в аморфном кремнии. 4, 686
- Соловьев Г. Г., см. Остроумов В. И. 7, 1273
- Соловьев Н. Н., см. Галкин М. Г. 6, 1122
- Сологуб В. В., см. Арушанов Э. К. 2, 338
- Солодка Т. И., см. Горфинкель В. Б. 10, 1759
- Соснин М. Г., см. Добровинский Ю. М. 6, 1149
- Соснин М. Г., см. Неймаш В. Б. 2, 206
- Спивак Б. З., см. Зюзин А. Ю. 2, 341
- Спицын А. В., см. Тигиняну И. М. 10, 1814
- Сресели О. М., см. Беляков Л. В. 5, 906
- Сталерайтис К. К., см. Пожела Ю. К. 5, 949
- Стамкулов А. А., см. Резников Б. И. 9, 1634
- Стамкулов А. А., см. Резников Б. И. 9, 1640
- Станкевич Е. Т., см. Курбанов К. Р. 8, 1509
- Стариков Е. В., Шикторов П. Н. Новый подход к расчету спектра дифференциальной подвижности горячих носителей заряда: прямое моделирование градиента функции распределения методом Монте-Карло. 1, 72
- Стариков М. Н., см. Балагуров Л. А. - 1, 168
- Стариков М. Н., см. Балагуров Л. А. 11, 1967
- Старосельцева С. П., см. Воронина Т. И. 6, 1129
- Старосельцева С. П., см. Воронина Т. И. 7, 1230
- Старостин К. В., см. Гродненский И. М. 7, 1223
- Старчик М. И., см. Гроза А. А. 12, 2244
- Стась В. Ф., см. Бобрикова О. В. 1, 143
- Стась В. Ф., см. Бобрикова О. В. 12, 2236
- Стафеев В. И., см. Пономаренко В. П. 1, 62
- Стафеев В. И., см. Салмин Е. А. 6, 1142
- Стельмах В. Ф., см. Доросинец В. А. 4, 761
- Стельмах Н. М., см. Журавлев А. Б. 2, 352
- Стельмах Н. М., см. Журавлев А. Б. 7, 1208
- Стельмах О. Б., Чекурин В. Ф. Поверхностная релаксация энергии и эффект Бенедикса в полупроводниках. 9, 1698
- Степанов Ю. А., см. Агемян В. Ф. 12, 2240
- Степанцова И. В., см. Картавых А. В. 6, 1004
- Страхов В. А., см. Карачевцева М. В. 11, 1936
- Стрекалов В. Н. Неравновесное испарение, вызванное безызлучательной рекомбинацией электрон-дырочных пар: распределение по энергиям. 2, 315
- Стрельницкий В. Е., см. Гавриленко В. И. 7, 1302
- Стрельчук А. М., см. Аникин М. М. 2, 298
- Стрельчук А. М., см. Аникин М. М. 9, 1574
- Стрельчук В. В., см. Артамонов В. В. 11, 1961
- Стриха В. И., Ильченко В. В., Мездрогина М. М., Андреев А. А. Электрофизические свойства кон-

- тактов с барьером Шоттки на аморфном гидрированном кремнии. 3, 461
- Стриха М. В., см. Авраменко В. А. 6, 1117
- Строкан Н. Б., см. Андреев В. М. 6, 1096
- Строкан Н. Б., см. Андреев В. М. 8, 1526
- Строкан Н. Б., см. Андреев В. М. 9, 1629
- Строкан Н. Б., см. Андреев В. М. 11, 2039
- Строкан Н. Б., см. Еремш В. К. 7, 1239
- Стругов Н. А., см. Алфёров Ж. И. 6, 1031
- Стругов Н. А., см. Алфёров Ж. И. 12, 2111
- Стругов Н. А., см. Воронина Т. И. 1, 147
- Стружкин В. В., Еремец М. И. Возбужденные состояния акцепторов в алмазе в приближении эффективной массы. 8, 1488
- Стук А. А., см. Антоненко А. Х. 5, 887
- Стусь Н. М., см. Андрушко А. И. 5, 789
- Стусь Н. М., см. Матвеев Б. А. 7, 1244
- Стучинский В. А., см. Антоненко А. Х. 5, 887
- Стучинский В. А., см. Болотов В. В. 1, 49
- Стучинский В. А., см. Болотов В. В. 8, 1405
- Стыс Л. Е., см. Балагуров Л. А. 1, 168
- Субашиев В. К., см. Аршев И. П. 2, 325
- Субашиев В. К., см. Аршев И. П. 6, 1068
- Судейменов Т., см. Глазов В. М. 11, 1943
- Сулима О. В., см. Андреев В. М. 8, 1391
- Султанов Н. А., см. Лебедев А. А. 1, 16
- Сулженко П. С., см. Антоненко В. И. 2, 223
- Сулженко П. С., см. Антоненко В. И. 4, 758
- Сур И. В., см. Касян А. И. 6, 1127
- Сусов Е. В., см. Аронзон Б. А. 5, 897
- Суханов В. Л., см. Берман Л. С. 5, 844
- Сухоруков О. Г., см. Греков Е. В. 4, 735
- Сушкевич К. Д., см. Коваль А. В. 5, 932
- Счастный В. В., см. Кучинский П. В. 4, 634
- Сыркин А. Л., см. Аникин М. М. 1, 133
- Сыркин А. Л., см. Аникин М. М. 2, 298
- Сыркин А. Л., см. Аникин М. М. 9, 1574
- Сыркин А. Л., см. Вишневская Б. И. 4, 664
- Сыроежкин С. М., см. Карпова И. В. 4, 609
- Сыродоев Г. А., см. Крючков С. В. 9, 1695
- Сысоев Б. И., Руднев Е. В., Антюшин В. Ф. Поверхностная подвижность в полупроводниковой гетероструктуре с поляризованными рассеивающими центрами в изолирующем слое. 10, 1871
- Сысоев Б. И., см. Антюшин В. Ф. 5, 902
- Тагиров Э. В., см. Гашимадзе Ф. М. 7, 1328
- Таиров М. А., см. Бекимбетов Р. Н. 6, 1101
- Таиров М. А., см. Константинова Н. Н. 9, 1580
- Таиров М. А., см. Константинова Н. Н. 9, 1699
- Таиров М. А., см. Лунев А. В. 6, 1115
- Таиров Ю. М., см. Аникин М. М. 2, 298
- Талалакин Г. П., см. Андрушко А. И. 5, 789
- Талалакин Г. П., см. Матвеев Б. А. 7, 1244
- Талбаев Б. М., см. Абдулгафаров С. Е. 7, 1171
- Тамендаров М. Ф., см. Мукашев Б. Н. 6, 1020
- Танатар М. А., см. Горбенко Н. В. 11, 1915
- Тарасевич А. Д., см. Кучинский П. В. 4, 634
- Тарасик М. И., Шварков Д. С., Янченко А. М. Исследование свойств симметричных дефектов структуры в полупроводниках методом пьезо-холл-эффекта. 1, 97
- Тарбаев Н. И., Сальков Е. А., Шецельский Г. А. Излучательная рекомбинация халькогенидов кадмия, индуцированная низкотемпературной пластической деформацией. 8, 1428
- Таскинбоев Р., см. Полупанов А. Ф. 1, 112
- Таурбаев Т. И., см. Резников Б. И. 9, 1634
- Таурбаев Т. И., см. Резников Б. И. 9, 1640
- Темпер Э. М., см. Итальянцев А. Г. 5, 834
- Тер-Мартirosян А. Л., см. Гарбузов Д. З. 4, 657
- Терентьев Я. В., см. Дмитриев А. П. 6, 1045
- Терехов А. С., см. Журавлев К. С. 5, 777
- Теруков Е. И., см. Бабаев А. А. 5, 927
- Теруков Е. И., см. Болд З. 12, 2173
- Тигиняну И. М., Пышняк Н. Б., Спицын А. В., Урсаки В. В. Влияние имплантации ионов собственных компонентов на электрические свойства кристаллов GaAs. 10, 1814
- Тигиняну И. М., см. Георгобиани А. Н. 1, 3
- Тигиняну И. М., см. Георгобиани А. Н. 6, 1110
- Тигиняну И. М., см. Калинушкин В. П. 6, 1112
- Тигиняну И. М., см. Нокашной И. И. 6, 1108
- Тикуннов А. В., см. Алфёров Ж. И. 6, 1031
- Тикуннов А. В., см. Гарбузов Д. З. 6, 1035
- Тимощук В. С., см. Федосов А. В. 7, 1297
- Тимощук В. С., см. Федосов А. В. 9, 1704
- Титаренко С. Г., см. Артемьев В. А. 4, 750
- Титков А. Н., см. Журавлев А. В. 2, 352
- Титков А. Н., см. Пикус Г. Е. 2, 185

- Т и т о в А. С., см. Винников А. Я. 3, 390
- Т и ш к и н М. В., см. Марков А. В. 1, 44
- Т о д у а П. А., см. Веденев С. И. 5, 936
- Т о к а р е в Ю. Н., см. Абдулгафаров С. Е. 7, 1171
- Т о к м а н И. Д., см. Генкин Г. М. 12, 2151
- Т о к м о л д и н С. Ж., см. Мухашев Б. Н. 6, 1020
- Т о к р а н о в В. Е., см. Алфёров Ж. И. 12, 2105
- Т о к р а н о в В. Е., см. Алфёров Ж. И. 12, 2111
- Т о л б а н о в О. П., см. Белобородов П. Ю. 4, 755
- Т о л с т и х и н В. И. Магнитотранспорт горячих электронов в многослойных гетероструктурах GaAs/AlGaAs. 2, 317
- Т о л с т и х и н В. И. Влияние рекомбинации на поверхности и в области пространственного заряда на фоточувствительность поверхностно-барьерных структур.\* 3, 564
- Т о л с т и х и н В. И., см. Пищалко В. Д. 9, 1617
- Т о л с т и х и н В. И., см. Пищалко В. Д. 11, 2014
- Т о л с т о б р о в М. Г., см. Берман Л. С. 5, 844
- Т о л с т о б р о в М. Г., см. Берман Л. С. 12, 2169
- Т о л у т и с Р. Б., см. Руйбис Г. С. 3, 516
- Т о м а ш ю н а с Р., см. Юшка Г. 10, 1831
- Т о м ч у к П. М., см. Дыкман И. М. 4, 768
- Т о р и ш н ы й В. И., см. Баранский П. И. 11, 2069
- Т о р и ш н ы й В. И., см. Баранский П. И. 12, 2214
- Т р а в н и к о в В. В., см. Жпляев Ю. В. 10, 1885
- Т р а х б р о т Б. М., см. Карумидзе Г. С. 10, 1848
- Т р и п а ч к о Н. А., см. Кустов В. Е. 2, 313
- Т р и н а ч к о Н. А., см. Кустов В. Е. 12, 2220
- Т р о ф и м е н к о Е. Е., см. Кушир П. Г. 4, 582
- Т р о ш к о в С. И., см. Мезрин О. А. 1, 176
- Т р о я н Ю. Г., Спизов Ф. Ф. Рекомбинация неравновесных носителей заряда в монокристаллах  $Pb_{0.8}Sn_{0.2}Te$ . 8, 1408
- Т р у н о в В. А., см. Итальянцев А. Г. 5, 834
- Т р у ф а н о в А. И., см. Остроумов В. И. 7, 1273
- Т у л а н о в В., см. Алибаев А. С. 3, 565
- Т у л а н о в В., см. Алибаев А. С. 3, 566
- Т у р о в с к и й Б. М., см. Бабицкий Ю. М. 2, 307
- Т у р с у н о в А. А., см. Бахадырханов М. К. 9, 1716
- Т у р с у н о в Н. А., см. Мирзаев А. 7, 1171
- У б а й д у л л а е в М. И., см. Атакулов Б. А. 3, 530
- У г р и н Ю. О., Шерегий Е. М. Овкладе различных типов носителей тока в явления переноса в  $p$ -InSb. 8, 1375
- У д љ а н и ц к и й К. С., см. Савчук А. И. 3, 512
- У м а н с к и й В. Е., см. Конников С. Г. 10, 1803
- У н д а л о в Ю. К., см. Бекимбетов Р. Н. 6, 1101
- У н д а л о в Ю. К., см. Лунев А. В. 6, 1115
- У р а л ь ц е в И. Н., см. Ивченко Е. Л. 5, 784
- У р а л ь ц е в И. Н., см. Копьев П. С. 3, 424
- У р а л ь ц е в И. Н., см. Копьев П. С. 4, 597
- У р с а к и В. В., см. Георгобини А. Н. 6, 1110
- У р с а к и В. В., см. Тигиняну И. М. 10, 1814
- У р ю п и н С. А., см. Гарасько Г. И. 2, 293
- У т е н к о В. И., см. Акулович Н. И. 9, 1720
- У т к и н - Э д и н Д. П., см. Аблова М. С. 1, 20
- У т к и н - Э д и н Д. П., см. Балагуров Л. А. 1, 155
- У ш а к о в В. В., см. Пономарев В. Н. 9, 1563
- У ш а к о в а Т. Н., см. Бакимбетов Р. Н. 6, 1101
- Ф а й н б е р г В. И., см. Конакова Р. В. 10, 1754
- Ф а р а д ж е в Б. Г., см. Арешев И. П. 2, 325
- Ф а р а д ж е в Б. Г., см. Арешев И. П. 6, 1068
- Ф а р а д ж о в А. И., см. Глазов В. М. 11, 1929
- Ф а р а д ж о в А. И., см. Глазов В. М. 12, 2156
- Ф е д о р е н к о Л. Л., см. Алмазов Л. А. 8, 1337
- Ф е д о р о в а М. Б., см. Сандомирский В. Б. 12, 2209
- Ф е д о с о в А. В., Панасюк Л. И., Тимощук В. С. Пьезосопротивление облученного германия. 7, 1297
- Ф е д о с о в А. В., Тимощук В. С., Ящинский Л. В. Об определении параметра анизотропии подвижности в  $n$ -Si. 9, 1704
- Ф и л а т о в А. Л., см. Сандомирский В. Б. 12, 2209
- Ф и л а т о в а Е. О., см. Смирнов И. Н. 2, 357
- Ф и л а т о в а Е. С., см. Васин О. И. 7, 1299
- Ф и л и к о в В. А., Кустов В. Е. Ф., Акимов О. Е. К расчету энергетических зон тетраэдрических полупроводников.\* 5, 958
- Ф и л и п е н к о Л. А., Коротеев Ю. М. Кластерный расчет связанных состояний кислорода в кремнии. 7, 1313
- Ф и р с о в В. И., см. Батунина А. В. 7, 1308
- Ф и с т у л ь В. И., см. Бобровников Ю. А. 2, 301
- Ф и ш к о в А. В., см. Зюзин А. Ю. 2, 341
- Ф о л о м и н П. И., см. Коваль А. Н. 9, 1601
- Ф р а н ц у з о в А. А., см. Охонин С. А. 5, 811
- Ф р а с у н я к В. М., см. Глузман Н. Г. 7, 1321
- Ф р о л о в В. В., Мухашев Б. Н. Изменение электронной структуры ва-

- кансии и дивакансии в кремнии при пассивации связей водородом.\* 9, 1715
- Фукс Б. И. О влиянии флуктуаций потенциала на измерения ГУ методами емкостной спектроскопии. 7, 1330
- Фукс Б. И., см. Винокуров Л. А. 11, 1986
- Фурман А. С. Динамика экранирования электрического поля в полупроводнике с глубоким примесным уровнем. 12, 2138
- Хайбуллин И. Б., см. Байзитов Р. М. 1, 79
- Хайбуллин И. Б., см. Закиров Г. Г. 5, 947
- Хайденрайх Й., см. Брайтеншгайн О. 9, 1687
- Халфин В. Б., см. Гарбузов Д. З. 4, 657
- Халфин В. Б., см. Гарбузов Д. З. 6, 1035
- Халфил В. Б., см. Соколова З. Н. 12, 2124
- Хаммедов А. М., см. Андреев В. М. 8, 1391
- Ханкина С. И., см. Буртыка М. В. 9, 1718
- Харченко В. А., см. Антоненко А. Х. 5, 887
- Харченко В. А., см. Герчиков Л. Г. 5, 863
- Харченко В. А., см. Мастеров В. Ф. 1, 118
- Харьков А. А., см. Панов В. И. 12, 2243
- Хасиева Р. В., см. Гольдберг Ю. А. 9, 1712
- Хвостиков В. П., см. Алфёров Ж. И. 10, 1775
- Хельмаул А., см. Коваль А. В. 5, 932
- Хижняк Б. И., см. Бакши И. С. 12, 2182
- Хизанишвили Э. Г., см. Качлишвили З. С. 8, 1507
- Хлудков С. С., см. Белобородов С. С. 4, 755
- Хлудкова Л. С., см. Гермогенов В. П. 5, 849
- Хмырова И. И., см. Рыжий В. И. 7, 1277
- Ходжаев К. Х., см. Абдурахманов К. П. 11, 2088
- Ходжаев К. Х., см. Аблова М. С. 1, 20
- Ходова Г. В., см. Аршев И. П. 6, 1068
- Хохлов А. Ф., Машин А. И., Ершов А. В., Машин Н. И., Игнатьева Е. А. Ионно-лучевое легирование аморфного кремния, содержащего изovalентную примесь германия. 8, 1511
- Хохлов А. Ф., см. Павлов Д. А. 5, 929
- Хохлов А. Ф., см. Павлов Д. А. 12, 2187
- Хохряков О. Д., см. Мастеров В. Ф. 1, 118
- Хрисанов В. А., см. Соловьев В. Н. 4, 686
- Хромов А. А., см. Бушуева Г. В. 2, 201
- Хрящев Г. С., см. Герасименко Н. Н. 4, 753
- Хуцишвили Э. В. Оптическое исследование кислорода в сплавах Si—Ge.\* 5, 959
- Цанев В. С., см. Катков В. М. 5, 959
- Царенков Б. В., см. Аникин М. М. 1, 133
- Царенков Б. В., см. Вишневская Б. И. 4, 664
- Царенков Б. В., см. Гольдберг Ю. А. 3, 555
- Царенков Б. В., см. Гольдберг Ю. А. 9, 1712
- Царенков Б. В., см. Константинов О. В. 1, 129
- Царенков Б. В., см. Резников Б. И. 9, 1634
- Царенков Б. В., см. Резников Б. И. 9, 1640
- Царенков Г. В., см. Резников Б. И. 4, 704
- Царенков Г. В., см. Резников Б. И. 9, 1634
- Царенков Г. В., см. Резников Б. И. 9, 1640
- Цвейбак И. Я., см. Якимчук Д. Ю. 8, 1474
- Цветков В. Ф., см. Аникин М. М. 2, 298
- Цидильковский И. М., см. Глузман Н. Г. 7, 1321
- Цидильковский И. М., см. Лончаков А. Т. 5, 839
- Цидильковский И. М., см. Лончаков А. Т. 8, 1396
- Цидильковский И. М., см. Матвеев Г. А. 5, 799
- Цидильковский Э. П., см. Берковская Ю. Ф. 5, 855
- Цидильковский Э. П., см. Гельмонт Б. Л. 10, 1888
- Цякунов А. В., см. Блецкан Н. И. 12, 2223
- Циуляну Д. И. О формировании барьера Шоттки—Мотта на контактах металл—халькогенидный стеклообразный полупроводник. 7, 1181
- Цмоць В. М., см. Добровинский Ю. М. 6, 1149
- Цмоць В. М., см. Довбыш Л. Е. 2, 359
- Цюнди К. Д., см. Аверьянов В. Л. 11, 2093
- Цященко Ю. П., см. Грехов А. М. 2, 273
- Цященко Ю. П., см. Грехов А. М. 5, 954
- Чайковский И. А., см. Герман А. И. 10, 1862
- Чалай И. И., см. Курмантев Ш. Д. 12, 2244
- Чалдышев В. В., см. Амусья В. М. 2, 342
- Чалай В. П., см. Гарбузов Д. З. 4, 657
- Чекуриц В. Ф., см. Стельмах О. Б. 9, 1698
- Челноков В. Е., см. Аникин М. М. 1, 133
- Челноков В. Е., см. Аникин М. М. 2, 298
- Челноков В. Е., см. Вишневская Б. И. 4, 664
- Черников Е. В., см. Войцеховский А. В. 12, 2226
- Чернобровцева М. Д., см. Баширов Р. И. 3, 479
- Чернобровцева М. Д., см. Гавриленко В. И. 7, 1233
- Черняев В. В., см. Пономарев В. Н. 9, 1563
- Черюканов С. Д., см. Кавалаяускас А. А. 12, 2177

- Ч е с н и с А. А., Г а ш к а К. И., О г н и н-  
с к а с А. К., Б а л ь ч ю н а с В. Ч.  
О признаках проявления многофононной  
ионизации локальных центров в некри-  
сталлическом GaTe<sub>3</sub>. 6, 1132
- Ч е с н о к о в С. А., см. Кустов В. Е. 12,  
2220
- Ч и п е н к о Г. В., см. Баранский П. И.  
11, 2069
- Ч и п е н к о Г. В., см. Баранский П. И.  
12, 2214
- Ч и с т ь я к о в В. М., см. Кошников С. Г.  
10, 1803
- Ч и х р а й Е. В., см. Колодкин Л. Г. 5, 821
- Ч и х р а й Е. В., см. Мукашев Б. Н. 6,  
1020
- Ч и ш к о В. Ф., см. Якимчук Д. Ю. 8,  
1474
- Ч у г у е в а З. И., см. Воронина Т. И. 6,  
1129
- Ч у д и н о в С. М., см. Исмаилов Ж. Т. 3,  
375
- Ч у к и ч е в М. В., см. Горбань И. С. 9,  
1718
- Ч у л к о в а Г. М., см. Воеводин Е. И. 3,  
540
- Ч у м а к о в Н. К., см. Аронзон Б. А. 5,  
897
- Ш а б а л и н А. В., см. Матвеев Б. А. 7,  
1244
- Ш а д р и н В. Д., см. Горшкова Т. А. 2,  
229
- Ш а й м е е в С. С., см. Аёшин А. И. 4, 692
- Ш а й м е е в С. С., см. Антонова И. В. 6,  
998
- Ш а л ь т и с Р., см. Барейкис В. 6, 1040
- Ш а н и н а Б. Д., см. Бабич В. М. 5, 956
- Ш а р о н о в а Л. В., Полянская  
Т. А., Нажмуудинов Х. Г., К а -  
р я е в В. Н., З а й ц е в а Л. А. Вы-  
сота барьера Шоттки Au—GaAs<sub>1-x</sub>Sb<sub>x</sub>. 4,  
93
- Ш а т а л о в В. М., см. Панченко О. Ф. 9,  
1720
- Ш а т к о в с к и й Е. В., см. Диджюлис  
А. А. 8, 1412
- Ш а х л е в и ч Л. Н., см. Кучинский П. В.  
4, 634
- Ш а х л е в и ч Л. Н., см. Кучинский П. В.  
7, 1213
- Ш а х о в ц о в В. И., см. Грехов А. М. 2,  
285
- Ш а х о в ц о в В. И., см. Добровинский  
Ю. М. 6, 1149
- Ш а х о в ц о в В. И., см. Крайчинский  
А. Н. 2, 215
- Ш а х о в ц о в В. И., см. Кустов В. Е. 2,  
313
- Ш а х о в ц о в В. И., см. Кустов В. Е.  
12, 2220
- Ш а х о в ц о в В. И., см. Неймаш В. Б. 2,  
206
- Ш а ш к о в а В. В., см. Агринская Н. В.  
7, 1248
- Ш в а р к о в Д. С., см. Тарасик М. И. 4,  
97
- Ш в е д к о в И. В., см. Бабаев А. А. 5,  
927
- Ш в е ц В. А., см. Мардежов А. С. 7, 1306
- Ш е в ч е н к о Н. В., см. Беляев А. Е. 2,  
335
- Ш е г а й О. А., см. Якушева Н. А. 11,  
2083
- Ш е й н к м а н М. К., см. Горбенко Н. В.  
9, 1651
- Ш е й н к м а н М. К., см. Горбенко Н. В.  
11, 1915
- Ш е м а р д о в С. Г., см. Александров  
П. А. 4, 731
- Ш е п е л ь с к и й Г. А., см. Тарбаев Н. И.  
8, 1428
- Ш е р е г и й Е. М., см. Угрин Ю. О. 8,  
1375
- Ш е р и м б е т о в Т., см. Абдурахманов  
К. П. 3, 510
- Ш е с т а к о в а Е. Ф., см. Веденеев С. И.  
5, 936
- Ш е х о в ц о в Л. В., см. Григорьев Н. И.  
10, 1764
- Ш е х о в ц о в Н. А., Вязьмитинов  
И. А., Пестришин А. А. Резонанс-  
ное поглощение электромагнитного излу-  
чения миллиметрового диапазона герма-  
нием.\* 5, 958
- Ш и к А. Я. Оптическое поглощение на  
гетерогранице. 10, 1843
- Ш и к А. Я., Ш м а р ц е в Ю. В. О реали-  
зации одномерных и квазиодномерных  
электронных каналов на вивциальных  
и профилированных поверхностях полу-  
проводников. 6, 1091
- Ш и к А. Я., см. Асрян Л. В. 4, 613
- Ш и к А. Я., см. Асрян Л. В. 12, 2199
- Ш и к А. Я., см. Козырев С. В. 1, 105
- Ш и к А. Я., см. Крецук А. М. 4, 604
- Ш и к А. Я., см. Мартисон М. Ю. 6, 1075
- Ш и к А. Я., см. Петросян С. Г. 12, 2192
- Ш и к т о р о в П. Н., см. Стариков Е. В.  
1, 72
- Ш и л е н а с А. Л., см. Кавалаяскас А. А.  
12, 2177
- Ш и м а н с к и й И. В., см. Пономаренко  
В. П. 1, 62
- Ш и м у л и т е Е. А., см. Кавалаяскас  
А. А. 12, 2177
- Ш и м у л и т е Е. Л., см. Пека Г. П. 1,  
150
- Ш и м у л и т е Е. А., см. Пека Г. П. 4,  
618
- Ш и н д и ч В. Л., см. Добровинский Ю. М.  
6, 1149
- Ш и н д и ч В. Л., см. Кустов В. Е. 12,  
2220
- Ш и н д и ч В. Л., см. Неймаш В. Б. 2, 206
- Ш и р о к о в а Н. А., см. Акимов Б. А.  
2, 248
- Ш и ш и я н у Ф. С., см. Показной И. И. 6,  
1108
- Ш к л о в с к и й Б. И., см. Левин Е. И. 4,  
642
- Ш к л о в с к и й Б. И., см. Райх М. Э.  
11, 1979
- Ш л е н с к и й А. А., см. Брук А. С. 10,  
1792
- Ш м а р ц е в Ю. В., см. Амуся В. М. 2,  
342
- Ш м а р ц е в Ю. В., см. Гореленок А. Т.  
1, 35
- Ш м а р ц е в Ю. В., см. Крецук А. М. 4,  
604
- Ш м а р ц е в Ю. В., см. Шик А. Я. 6, 1091
- Ш м а т к о Г. Г., см. Гроза А. А. 12, 2244
- Ш м и д т Н., см. Галванаускас А. М. 9,  
1672
- Ш о в к у н Д. В. О влиянии магнитопри-  
месных резонансов на фотопроводимость  
p-Ge. 9, 1569



- Шовкун Д. В., см. Гантмахер В. Ф. 4, 575
- Шокина Е. В., см. Андреев В. М. 11, 2039
- Шонтия В. П., см. Показной И. И. 6, 1103
- Шофман С. Г., см. Горфинкель В. Б. 5, 793
- Шпидар Л. И., Ясковец И. И. Особенности проводимости полупроводников, обусловленные дефектами с сильным электрон-решеточным взаимодействием. 3, 547
- Штельмах К. Ф., см. Мастеров В. Ф. 4, 654
- Штрапчин Г. Л., см. Аронов Ю. Г. 5, 893
- Шубак М. И., см. Довбыш Л. Е. 2, 359
- Шулепников М. Н., см. Батунича А. В. 7, 1308
- Шумский В. Н., см. Васин О. И. 7, 1299
- Шустер Э. М., см. Баранюк В. Б. 4, 733
- Шустов Б. А., см. Афонин О. Ф. 1, 56
- Шустов С. Д., см. Архипов В. И. 2, 276
- Шяткус А., см. Дедулевич С. 4, 744
- Щербakov Е. А., см. Жук Б. В. 8, 1353
- Щербakov Е. А., см. Жук Б. В. 10, 1780
- Щетинин А. Г., см. Гостев А. В. 8, 1516
- Эльтазаров Б. Т., см. Веденев С. И. 5, 936
- Энтин М. В., см. Вильмс П. П. 11, 1905
- Энтин М. В., см. Ефанов А. В. 3, 386
- Эфрос Ал. Л., см. Голубев В. Г. 8, 1416
- Эфрос Ал. Л., см. Иванов М. Г. 4, 628
- Эфрос Ал. Л., см. Копьев П. С. 3, 424
- Эфрос Ал. Л., см. Соколова З. Н. 12, 2124
- Юабов Ю. М., см. Аронов Д. А. 9, 1719
- Южанин А. Г., см. Гафийчук В. В. 11, 2051
- Юконис Г., см. Юшка Г. 10, 1831
- Юнис М., см. Пихтин А. Н. 6, 1107
- Юнович А. Э., см. Качабеков М. М. 5, 815
- Юрова Е. С., см. Картавых А. В. 6, 1004
- Юрова Е. С., см. Картавых А. В. 11, 2035
- Юрченко В. Б., см. Глазман Л. И. 3, 465
- Юрченко В. Б., см. Гуревич Ю. Г. 11, 1955
- Юрченко И. А., см. Горбенко Н. В. 11, 1915
- Юршенас С., см. Вайнерт Х. 12, 2232
- Юрьев В. А., см. Калинушкин В. П. 6, 1112
- Юшка Г., Томашюнас Р., Юконис Г. Диффузионная рекомбинация в аморфном полупроводнике. 10, 1831
- Яблоновский Е. И., см. Малютенко В. К. 4, 593
- Явид В. Ю. Определение параметров рекомбинационных центров посредством дифференциального анализа температурных зависимостей времени жизни неосновных носителей заряда. 5, 824
- Явич Б. С., см. Алферов Ж. И. 12, 2111
- Ягудаев Д. А., см. Аронов Д. А. 9, 1719
- Якимки В. Н., Ушаков В. В., Гиниус А. А., Вавилов В. С., Седелъников А. Ф., Дравин В. А., Черняев В. В., Пономарев Н. Ю. Лазерный отклик имплантированного GaAs. Роль имплантационных дефектов. 9, 1563
- Якимов Е. Б., см. Брайтенштайн О. 9, 1687
- Якимов Е. Б., см. Ковенищikov С. В. 5, 922
- Якимчук Д. Ю., Давыдов М. С., Чижко В. Ф., Цввойбак И. Я., Крапухин В. В., Соколов И. А. Исследование вольтамперных характеристик гетеропереходов  $p\text{-Pb}_{0.8}\text{Sn}_{0.2}\text{Te}/n\text{-PbTe}_{0.92}\text{Sn}_{0.08}$ . 8, 1474
- Якобсон М. А., см. Сейсян Р. П. 7, 1304
- Яковенко А. А., см. Акулова Ю. А. 7, 1287
- Яковенко В. М., см. Буртыка М. В. 9, 1718
- Яковлев Д. Р., см. Ивченко Е. Л. 5, 784
- Яковлев Д. Р., см. Копьев П. С. 3, 424
- Яковлев Д. Р., см. Копьев П. С. 4, 597
- Яковлев И. И., см. Артамонов О. М. 4, 638
- Якубович С. Д., см. Журавлев А. В. 7, 1208
- Якунин М. В. Магнитофонный резонанс на горячих носителях в HgTe: влияние одноосной деформации и анизотропии. 8, 1452
- Якушева Н. А., Журавлев К. С., Шегай О. А. Об «очистке» арсенида галлия висмутом. 11, 2083
- Якушева Н. А., см. Журавлев К. С. 5, 777
- Янкевич Е. Б., см. Базулевич Ю. Ю. 12, 2245
- Янченко А. М., см. Тарасик М. И. 1, 97
- Ярашюнас К. Ю., см. Квасов Н. Т. 5, 806
- Яременко Н. Г., см. Карачевцева М. В. 11, 1936
- Ярошецкий И. Д., см. Беляков Л. В. 5, 906
- Ярошецкий И. Д., см. Дмитриев А. П. 6, 1045
- Ясковец И. И., см. Неймаш В. Б. 2, 206
- Ясковец И. И., см. Шиннар Л. И. 3, 547
- Ясевич И. Н., см. Абакумов В. Н. 2, 262
- Ясков А. Д., см. Пихтин А. Н. 6, 969
- Ящинский Л. В., см. Федосов А. В. 9, 1704